

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

오킨스전자 (080580)

반도체 테스트 시장의 올라운더

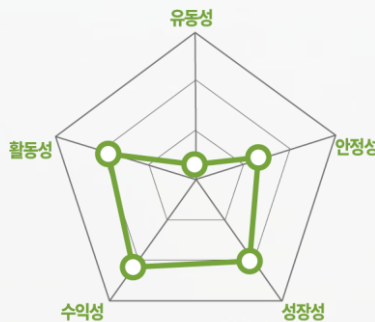
체크포인트

- 오킨스전자는 1998년 번인 소켓 국산화에 성공하며 설립되어 2014년 코스닥 상장한 반도체 테스트 솔루션 전문 기업. 동사는 번인 소켓, 테스트 소켓, MEMS 프로브핀(포고핀), 마그네틱 콜렛, 커넥터, 웨이퍼 및 패키지 테스트 용역 등 반도체 테스트 분야 전방위 사업을 영위
- 주요 고객사의 반도체 테스트 수요 확대 및 고부가 메모리 테스트 산업 성장에 따른 수혜를 예상. HBM/SOCAMM 수요 증가에 따라 동사 메모리 소켓 및 포고핀 매출액 성장 구간 진입한 것으로 판단. 또한, 다이 레벨 테스트 시장 개화에 따른 테스트 소켓 매출 확대를 기대
- 2026년 매출액, 영업이익은 1,405억 원(+48.9% YoY), 207억 원(+71.6% YoY) 전망. 주요 고객사의 CLT(Chambered Low-frequency memory Tester)장비 전환에 따른 동사 메모리 소켓 매출 증가가 예상. 또한, 글로벌 프로브카드 고객사 확대에 따른 포고핀 및 HBM 3사향 마그네틱 콜렛 매출 증가 등 반도체 테스트 산업 성장에 따른 수혜가 가능한 점에 주목

주가 및 주요이벤트

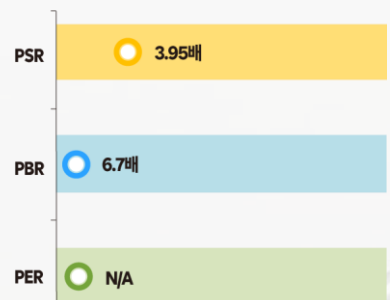


재무지표



주: 2024년 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2024년 기준, PBR은 3Q25 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

반도체 테스트 솔루션 전문 기업

오킨스전자는 1998년 설립해 2014년 코스닥 시장 상장한 반도체 테스트 솔루션 전문기업. 당사는 번인 소켓, 테스트 소켓, MEMS 프로브핀/포고핀, 마그네틱 콜렛, 커넥터, 웨이퍼/패키지 테스트 용역 등 반도체 테스트 분야 사업을 영위. 주요 사업은 BiTS 사업부(반도체 검사용 소켓 제조 사업)와 반도체 테스트 사업부, 기타로 구분되며, 3Q25 누적 매출 비중은 BiTS 사업부 89.6%, 반도체 테스트 용역 7.1%, 기타 3.3%를 기록

AI향 메모리 시장 확대에 따른 테스트 수요 증가 전망

Hyperscaler의 AI 관련 투자가 지속 확대되면서 HBM 최종 수요는 2026/2027년 각 +60%/+40% YoY 수준의 고성장이 예상되며, HBM의 스펙 또한 고도화되고 있음. 주요 HBM 제조사의 Capex 확대와 Advanced Packaging 전환은 웨이퍼 레벨 테스트 물량 증가 및 ASP 상승으로 이어짐. 또한, 동사의 경우 AI 메모리향 다이 레벨 테스트 소켓 매출 확대도 기대

성장 기대되는 2026년

2026F 매출액 1,405억 원(+48.9% YoY), 영업이익 207억 원(+71.6% YoY)을 전망. AI 서버향 LPDDR 채택과 HBM 수요 증가가 전사적인 매출 성장을 견인할 것으로 예상. BiTS 사업부의 경우 전년 대비 48.9% 성장한 1,245억 원을 전망하는데, 이는 크게 4가지 요인에 기인할 것으로 예상. 1) AI 서버향 LPDDR 수요 증가에 따른 CLT향 메모리 소켓(및 커넥터) 매출 확대, 2) 국내 주요 고객사의 AI향 테스트 소켓 물량 증가, 3) MEK향 점유율 확대에 따른 포고핀 매출 성장, 4) HBM 메모리 3사향 마그네틱 콜렛 적용 확대에 따른 매출 증가. 고마진 제품 매출 비중 확대와 판관비를 안정화 추세에 따른 OPM 14.7%(+1.9%p YoY) 전망

Forecast earnings & Valuation

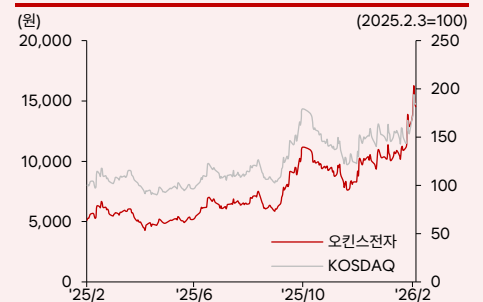
	2022	2023	2024	2025F	2026F
매출액(억원)	642	569	667	944	1,405
YoY(%)	8.2	-11.4	17.3	41.5	48.9
영업이익(억원)	26	-3	19	121	207
OP 마진(%)	4.1	-0.5	2.9	12.8	14.7
지배주주순이익(억원)	29	10	-54	80	160
EPS(원)	161	58	-306	394	778
YoY(%)	49.3	-64.1	적전	흑전	97.5
PER(배)	114.0	155.4	N/A	26.1	19.2
PSR(배)	5.1	2.8	1.2	2.2	2.2
EV/EBITDA(배)	336	21.9	9.8	9.0	11.1
PBR(배)	9.9	4.5	2.9	4.1	5.9
ROE(%)	8.4	3.0	-17.2	20.3	30.9
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (2/12)	14,910원
52주 최고가	16,270원
52주 최저가	4,285원
KOSDAQ (2/12)	1,125.99p
자본금	103억원
시가총액	3,069억원
액면가	500원
발행주식수	21백만주
일평균 거래량 (60일)	70만주
일평균 거래액 (60일)	83억원
외국인지분율	10.53%
주요주주	전진국 외 4 인
	제이피케이
	56.8%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	435	1109	1824
상대주가	210	512	869

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 매출액 증가율, 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

오킨스전자는 반도체 소켓 제조 및 테스트 서비스 전문 기업

오킨스전자는 1998년 설립되어
2014년 코스닥 상장한 반도체
소켓 제조 및 테스트 서비스 기업

오킨스전자는 1998년 텍사스 인스트루먼트(TI) 출신 전진국 대표이사가 번인 소켓 국산화를 목표로 설립한 반도체 테스트 솔루션 전문기업이다. 당시 국내 반도체 산업이 본격 성장하던 시기, 국내 메모리 업체들은 외산 소켓을 10배 이상 비싼 가격에 수입해 사용하고 있었고, 동사는 국내 최초로 번인 소켓 국산화에 성공하며 시장에 진입했다. 사명 오킨스(OKINS)는 OK와 INS(TI)를 합친 의미로, 반도체 테스트 솔루션 기업으로의 지향점을 담고 있다. 현재 약 28년의 업력을 보유한 동사는 번인 소켓, 테스트 소켓, MEMS 프로브핀(포고핀), 마그네틱 콜렛, 각종 커넥터, 웨이퍼 및 패키지 테스트 용역 등 반도체 테스트 분야 전방위 사업을 영위하고 있으며, 2014년 코스닥 시장에 상장했다.

동사는 2005년 중국 쑤저우 공장 설립, 2008년 자체 R&D 센터 설립을 통한 금형 기술 내재화 등 지속적인 기술 자립을 추진하며 반도체 테스트 시장의 올라운더로 성장해왔다. 초기 번인 소켓 중심이었던 사업 구조에서 나아가 자체 기술력을 바탕으로 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대했다. 2018년에는 삼성전자로부터 마그네틱 콜렛 공급 승인을 획득하며 연간 100억 원 규모의 신규 매출원을 확보했고, 이후 SK하이닉스, 마이크론까지 고객사로 확보했다. 2020년에는 센서뷰와 5G 네트워크용 소형 기지국 케이블을 공동 개발하고, 2022년 현대기아차 SQ인증을 획득하며 자동차 커넥터 시장까지 진출했다. 또한, 포고/프로브핀, 마그네틱 콜렛, COK, 커넥터 등 반도체 테스트 과정에 필요한 핵심 부품을 공급하고 있다. 여기에 더해 동사는 연간 약 50억 원 규모의 반도체 테스트 서비스 사업도 운영 중이다. 웨이퍼 및 패키지 테스트 설비를 통해 30여개 업체에 임가공 테스트 서비스를 제공하며, 포고핀 및 소켓 사업과의 시너지를 창출하고 있다. 2024년 ATS센터 설립, 2025년 1월 LPDDR5용 번인소켓 66.5억 원 규모 수주 등 지속적인 기술 개발과 사업 확장을 이어가고 있다.

본사는 경기 의왕 오전동으로, 13층 규모의 아파트형 공장인 본사에서 주력 제품의 가공과 조립을 수행하고 있다. 화성 송산 사업장은 소켓을 제조하는 내부 1차 제조를 해주는 사업장으로 대부분 내부 매출 기준으로 발생하며, 주로 마그네틱 콜렛, 커넥터, 사출, 프레스, 대형 가공 설비를 생산한다. 반도체 테스트 사업부는 웨이퍼 및 패키지 테스트 용역을 담당한다. 현재 인력은 정규직 기준 193명, 비정규직 포함 약 350명 규모이다.

오킨스전자 주요 연혁

1998~2011	2012~2021	2022~
1998 오킨스전자 설립(반인 소켓 최초 국산화) 1999 삼성전자, SK하이닉스 반인 소켓 승인 2002 경기도 유망 중소기업 선정 2004 ISO 14001, ISO 9001 인증 2005 중국 쑤저우 공장 설립 기술혁신형 중소기업 선정 2006 벤처기업 대상 수상(국무총리) 2008 송산 R&D 센터 설립 모범납세자 기획재정부 장관상 경기도 중소기업 기술혁신 대상 무역의 날 수출의 탑 수상	2012 의왕 상공 대상 수상 2014 코스닥 시장 상장 2016 대한민국 특허 대상(산업통상자원부) 우수기술연구센터(ATC) 지정 한국창의융합학회 최우수상 수상 기술평가 우수기업 인증(T-3 최우수) 2018 삼성전자 마그네틱 플랫 승인 2019 센서뷰와 5G 파트너십 체결 2021 ISO 45001 인증 일터혁신 우수기업	2022 HSMC SQ인증 SK하이닉스 마그네틱 플랫 승인 2023 벤처기업부에서 유망기업부로 선정 상공인의 날 산업부 장관상 2024 반도체 으뜸 기업 선정 경기도 표창수상 ATS Center 설립 2025 LPDDR 빈인 소켓 최대 수주 2026 SOCAMM양산 LPDDR6 공급

자료: 오킨스전자, 한국IR협회의 기업리서치센터

오킨스전자 주요 사업장



자료: 오킨스전자, 한국IR협회의 기업리서치센터

오킨스전자는 3Q25말 기준
연결대상 종속기업으로 비상장
2개사를 보유

오킨스전자의 종속기업은 중국 쑤저우에 위치한 Vision Tech Co., Ltd와 한국에 위치한 (주)한국영다반도체가 있다. Okins Electronics(SUZHOU) Co., LTD(지분 95.45%)의 경우 로직-아날로그·CIS(CMOS Image Sensor) 패키지 테스트에 특화되어 있으며, (주)한국영다반도체(지분 64.56%)는 반도체 검사용 장비 및 부품을 생산한다. 1H25말 기준 각 연결대상 종속기업의 자본총계는 Okins Electronics(SUZHOU) Co., LTD(지분 95.45%) 11.8억 원, (주)한국영다반도체(지분 64.56%) 8.3억 원이다.

오킨스전자 연결대상 종속기업 현황



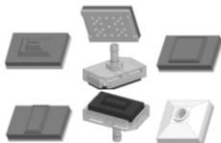
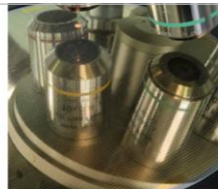
주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

주요 사업 및 매출 구성

3Q25 누적 비중은
BiTS 사업부 89.6%,
반도체 테스트 7.1%, 기타 3.3%

오킨스전자의 주요 사업은 BiTS 사업부(반도체 검사용 소켓 제조 사업) 과 반도체 테스트 사업부(반도체 테스트 용역 사업), 기타로 구분되며, 3Q25 누적 매출 비중은 **BiTS 사업부 89.6%, 반도체 테스트 사업부 7.1%, 기타 3.3%**이다. BiTS(Burn-In & Test Socket) 사업부는 크게 번인/테스트 소켓, 프로브핀/포고핀, 마그네틱 콜렛 매출로 구성되어 있다. 반도체 테스트 사업부는 웨이퍼 및 패키지 테스트 용역을 담당한다. 마지막으로 기타 매출은 커넥터 등의 매출로 구성된다. 참고로 아래의 사업부 구분은 주요 제품을 기준으로 나눈 것이다.

오킨스전자 주요 사업부

BiTS 사업부	Burn In Socket Test Socket(국내)	 [번인 소켓]		 [테스트 소켓]
	Burn In Socket Test Socket (해외)			
MEMS 사업부	Probe Pin Wire Probe			
송상 사업부	자동차 커넥터 마그네틱 콜렛 Mold&Press MCT	 [마그네틱 콜렛]		 [커넥터]
반도체 테스트	Test Service (Wafer & PKG)			 Wafer Test
	중국 법인	 Package Final Test		

자료: 오킨스전자, 한국IR협회의 기업리서치센터

Burn-in Socket(번인 소켓)

동사는 반도체 패키징 후 테스트 공정에서 사용되는 번인 소켓을 제조·납품하고 있다. 번인 테스트는 소비자 사용 환경 보다 가혹한 조건에서 불량률 사전 검출하는 스트레스 테스트로, 통상 섭씨 125도의 고온 환경에서 최대 48시간 동안 각 셀에 데이터를 반복적으로 읽고 쓰며 동작 여부를 검증한다. 동사의 번인 소켓은 DRAM 및 NAND 메모리 번인 테스트용으로 사용되며, 번인 테스트 장비에 장착되는 소모성 부품이다. 이에 따라 장비 수주 사이클과 무관하게 지속적인 교체 수요가 발생한다. 주요 경쟁사로는 일본의 Enplas, Yamaichi, 미국 BOYD, 한국의 마이크로컨택솔(MCS)등이 있다. 국내에서는 주로 동사와 MCS가 경쟁한다. 동사는 주로 삼성전자, 중국 CXMT, 테스트 장비 업체에 납품하고 있다. 한편, 동사의 국내 주요 메모리 업체의 경우, 파이널 테스트 단계에서 고효율 CLT(Chambered Low-frequency memory Tester)로의 전환을 추진중인데, 동사는 해당 CLT 장비용 번인 소켓을 공급하고 있다.

Test Socket(테스트 소켓)

테스트 소켓은 반도체 제조 공정의 최종 검사 단계에서 반도체 패키지와 테스트 보드를 연결하는 소모성 부품이다. 글로벌 시장의 주요 업체로는 Winway(대만), 리노공업(한국), Cohu(미국), Yamaichi(일본), ISC(한국) 등이 있다. 국내에서는 리노공업, ISC, 티에스이가 인텔, 퀄컴, AMD 등 시스템 반도체용 테스트 소켓 시장을 주도하고 있다.

동사는 테스트 소켓, 인터포저용 소켓 등 메모리 및 고대역폭 인터페이스 중심 영역에서 점유율을 확대하고 있다. 주요 제품으로는 테스트 소켓과 인터포저용 소켓이 있으며, 최근에는 앞서 언급한 고효율 CLT 장비에 사용되는 Low Frequency 테스트 소켓도 공급하고 있다. 동사의 주요 매출처는 Advantest(일본), 유니테스트, 티에프이, 엑시콘, 네오셈, 테크윙 등으로 반도체 테스트 장비 및 핸들러 업체들과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다.

Probe/Pogo pin(프로브/포고핀)

포고핀은 웨이퍼 테스트용 인터포저에 실장되는 스프링 핀이다. 일본 MJC의 국내 법인인 MEK(부천 소재)에 포고핀을 공급하고, MEK가 이를 기반으로 프로브카드를 제작하여 삼성전자 등 메모리 기업에 납품하고 있다.

Magnetic Collet(마그네틱 콜렛), COK(Change Over Kit) Connector(커넥터)

마그네틱 콜렛은 소모성 부품으로, 반도체 Chip을 Pick&Place 하거나 Die를 적층하고 Bonding 시 사용되는 Pick up Tool로, 단순히 보이지만 까다로운 제조 품질을 요구하는 고부가 제품이다. 삼성전자향 콜렛의 경우, 과거 독점 공급사였던 업체가 단가를 인상하자 삼성전자가 벤더 다변화를 추진했고, 6개 업체가 경쟁에 참여하였다. 이 과정에서 오킨스전자만 최종 승인되면서 사실상 솔벤더 지위를 확보하였다. 이후 오킨스전자는 SK하이닉스, 마이크론, OSAT(SFA 반도체, 시그네틱스, 하나마이크론), 세메스, 한화세미텍, 테크윙까지 고객사로 보유하고 있다. 마그네틱 콜렛 매출액은 크게 DRAM용과 HBM용으로 구분되며, HBM용 마그네틱 콜렛의 ASP가 더 높게 형성되어 있다. 마그네틱 콜렛은 기존 러버 콜렛 대비 기능성과 생산성 측면에서 진화한 방식으로 자성을 활용해 칩을 안정적으로 고정하고 이송할 수 있어 수율 개선이 가능하며, 오킨스전자의 경우 HBM 기술 변화에도 불구하고 안정적인 공급이 가능할 전망이다.

COK(Change Over Kit)는 마그네틱 콜렛 아래에서 패키지를 잡아주는 부품으로, 연간 약 30억 원 규모의 매출액이 안정적으로 발생한다. 커넥터 부문은 자동차 커넥터와 5G 통신용 커넥터로 구성된다. 동사는 현대자동차 및 기아자동차 커넥터 SQ 인증을 취득하였으며, 센서뷰와의 협업을 통해 5G 및 방산용 통신 커넥터도 개발했다. 센서뷰는 퀄컴 스몰셀용 커넥터를 승인받았으며, 동사는 센서뷰 지분 약 50억 원을 투자하여 보유하고 있다.

반도체 테스트 서비스 사업

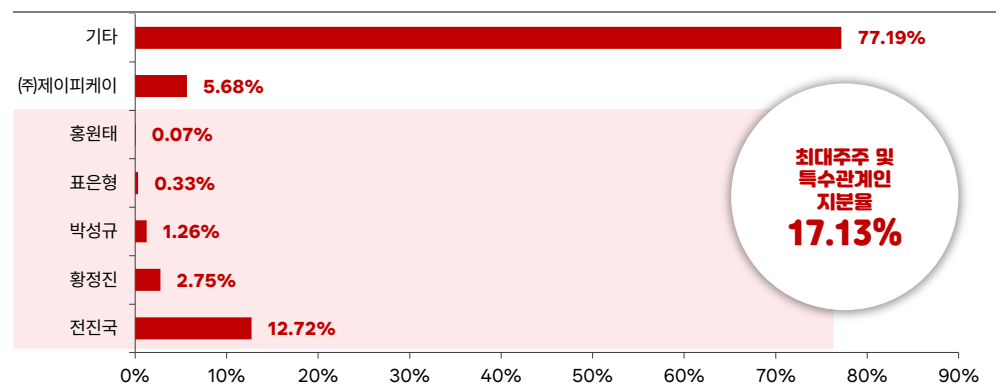
웨이퍼 및 패키지 테스트 설비를 통해 고객사의 웨이퍼, 패키지 완제품을 임가공 테스트하며, 패키지 테스트 비중이 약 70% 수준으로 파악된다. 주요 고객은 TP세미로, 중국 BYD향 패키지 테스트를 담당하며, 연간 약 50억 원의 매출을 기록하고 있다. 이외에도 국내 솔루엠, 아이케이세미콘, 어보브반도체 등 30여개 업체에 서비스를 제공하고 있다. 국내에서는 두산테스나가 대표적인 유사업체이다. 테스트 사업은 대규모 설비 투자가 필수적인 산업으로, 동사는 매년 20~30억 원 규모의 투자를 지속하며 설비 확충과 유지보수를 병행하고 있다. 향후 소켓 및 포고핀 사업과 연계된 시너지도 기대할 수 있다.

주주 구성

**3Q25말 기준 최대주주는
창업자 전진국 대표이사로,
지분 12.72% 보유**

오킨스전자의 최대주주는 창립자인 전진국 대표이사로 3Q25말 기준 지분 12.72%를 보유하고 있다. 전대표는 국민 대학교 금속공학과를 졸업하고 1987년 텍사스인스트루먼트(TI) 코리아에서 근무한 후, 1998년에 오킨스전자를 설립하여 현재까지 대표이사를 역임하고 있다. 최대주주인 전대표를 포함한 특수관계인 지분의 합은 17.13%로, 배우자 황정진(2.75%)과 임원 3명으로 구성되어 있다. 또한, 5% 이상 주주는 (주)제이피케이로, 지분 5.68%를 보유하고 있다. 참고로 당사는 2023년 9월 약 180억 원 규모의 전환사채를 발행한 후 약 153억 원 전환되었으며, 현재 누적 기준 CB 잔액은 약 27억 원이다. 잔여 물량 중 일정 부분은 우호 지분 성격의 법인이 보유한 것으로 파악되어 오버행 리스크는 제한적일 것으로 예상된다. 또한, 과거 외국인 지분율은 1% 미만 수준이었으나, 2025년에 들어 외국인 지분율이 상승했으며, 2026.02.06 기준 해외 기관 모건스탠리가 지분 4.65%를 보유하고 있다.

오킨스전자 주주 현황



주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터



산업 현황

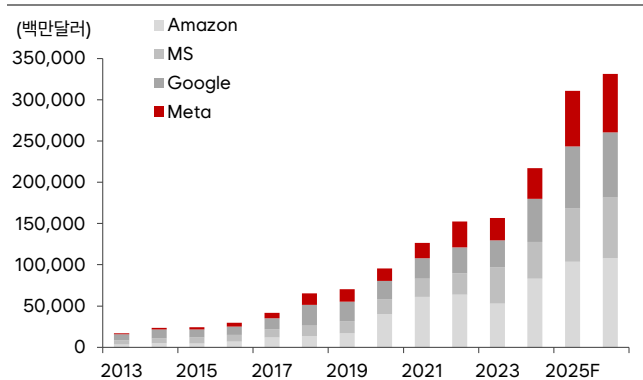
HBM4 전환에 따른 테스트 수요 증가 전망

INTRO: 왜 국내 반도체 테스트
시장에 주목해야 하는가

HBM은 AI 컴퓨팅 구현의 핵심 요소다. Hyperscaler의 AI 관련 투자가 지속 확대되면서 **HBM 최종 수요는 2026/27년 각각 +60%/+40% YoY 고성장할 것으로 예상되며, HBM의 스펙 또한 고도화**되고 있다. HBM의 고집적화(12단→16단→20단), 다이당 I/O 증가, 핀 속도 향상 등 모든 요소는 결국 테스트 중요성 증가로 귀결될 것이다.

현재 업계는 HBM3E에서 HBM4로 전환 중이다. HBM3→HBM3E 전환 사이클과 유사하게, HBM4 도입은 1) 메모리 테스트 시장 규모 확대, 2) 국내 메모리 테스트 업체들의 신규 수주 기회 확대로 이어질 것으로 판단된다. 실제로 Advantest는 최근 실적 발표에서 2026년 메모리 테스트 시장 규모를 22~27억달러로 제시했다(중간값 기준 YoY +20%). 또한, 3) HBM4부터 삼성전자와 SK하이닉스가 테스터 공급선 다변화를 본격화하면서 국내 업체 의존도를 높일 것으로 예상되며, 이는 국내 테스트 기업의 점유율 상승 기회가 될 것이다.

Hyperscaler의 CAPEX 추이 및 전망



자료: Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

HBM 스펙 비교

	양산시점	Per Die	Height(단)	Speed(Gbps)	I/O Count
HBM4E	2H26F	32Gb	8, 12, 16	>100	2,048
HBM4	2H25	24Gb	12, 16	8.0~10.0	2,048
HBM3E	2H24	24Gb	8, 12	8.0~9.8	1,024
HBM3	1H22	24Gb	8, 12	5.6~6.4	1,024
HBM2E	1H20	24Gb	4, 8	3.2~3.6	1,024
HBM2	2H18	24Gb	4, 8	2.0~2.4	1,024

자료: JEDEC, 한국IR협회의 기업리서치센터

한편, HBM3E에서 **HBM4로의 전환에 따라 테스트 시간이 증가할 것으로 전망**된다. HBM4는 HBM3E 대비 더 많은 I/O와 더 높은 핀 속도를 요구하며, 이는 열 부하 증가로 이어져 정밀한 열 관리가 필수적이다. 특히 고속 테스트, 번인 테스트, 고온/저온 테스트에 대한 중요성을 크게 높일 것으로 판단된다. HBM4의 번인 테스트 시간은 HBM3E 대비 1.5배~1.75배 증가할 것으로 추정된다. HBM3E에서 HBM4로, 그리고 향후 HBM4E 및 HBM5로 진화하면서 사양 복잡성 증가와 테스트 시간 연장이 불가피하다. 기존 Advantest(일본) 및 Teradyne(미국) 등 같은 기존 테스트 장비 업체들이 이러한 추세에 주요 수혜자가 될 것이나, 기존에 DDR/NAND에 집중해왔던 한국 메모리 테스트 업체들 역시 빠르게 성장하는 시장하는 반도체 테스트 시장에서의 성장을 예상한다.

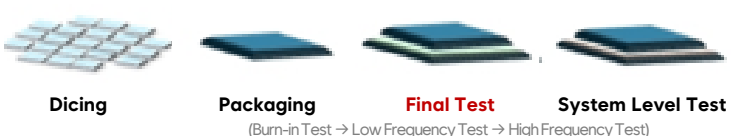
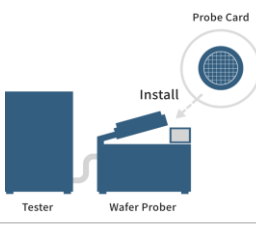
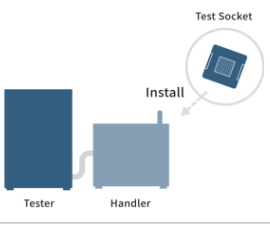
반도체 테스트 산업 개요

반도체 테스트 공정 흐름 및 개요

반도체 제조 공정은 웨이퍼에 공정을 진행하여 반도체 소자를 만드는 전공정(Front End)과 그 웨이퍼를 가지고 패키지/테스트하는 후공정(Back End)으로 나눌 수 있으며, 전/후공정 모두 검사 단계가 필수적이다.

검사 단계에는 여러 장비가 사용된다. 먼저, **ATE(Automatic Test Equipment)**는 반도체를 자동으로 테스트하는 핵심 장비이며, **인터페이스 보드**는 반도체와 ATE 사이에서 전기 신호를 전달한다. **프로브카드**와 **테스트 소켓**은 각각 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트에 사용되는 소모성 부품이다. 이 때, ATE는 보조 장비와 함께 작동한다. 웨이퍼 테스트에는 프로브 스테이션(Prober), 패키지 테스트에는 핸들러가 사용되며, 테스터가 원활히 작동하도록 지원한다.

반도체 제조 및 테스트 공정 흐름

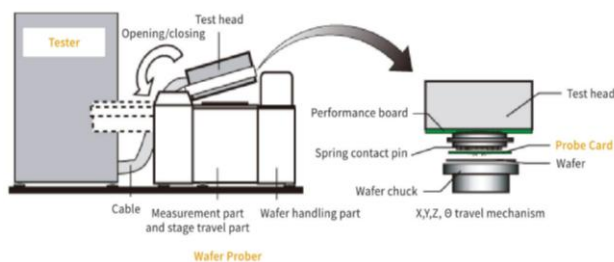
	Front End(전공정)	Back End(후공정)
Manufacturing Flow	 Wafer Fabrication Wafer Sort / Probing	 Dicing Packaging Final Test System Level Test (Burn-in Test → Low Frequency Test → High Frequency Test)
Testing Flow		
장비	ATE Prober	ATE Handler
소모성 부품	Probe Card Probe Interface Board	Sockets Device Interface Board

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

웨이퍼 레벨 테스트/프로브카드 산업 개요

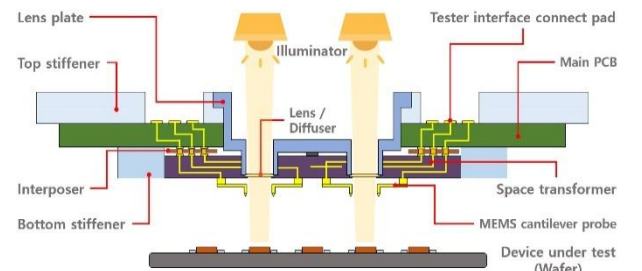
웨이퍼 테스트란 집적된 반도체 회로(IC)의 동작 여부를 검증하는 단계로, 크게 테스터(Tester)장비, 그리고 웨이퍼 프로버(Wafer Prober), 프로브카드로 구성되어 있다. 테스터는 전기 신호를 생성하고 측정 결과를 분석하는 본체이며, 케이블을 통해 테스트 헤드와 연결되어 있다. 테스트 헤드는 상하로 움직이며 인터페이스 보드를 통해 프로브카드에 전기 신호를 전달한다. 프로브 카드는 MEMS 프로브핀들이 방사형으로 배열되어 있어, 웨이퍼 표면과 정밀하게 접촉하여 전기적 신호를 전달하는 소모성 부품이다.

웨이퍼 테스트 시스템



자료: MJC, 한국IR협회의 기업리서치센터

프로브카드 단면도



자료: Willtechnology, 한국IR협회의 기업리서치센터

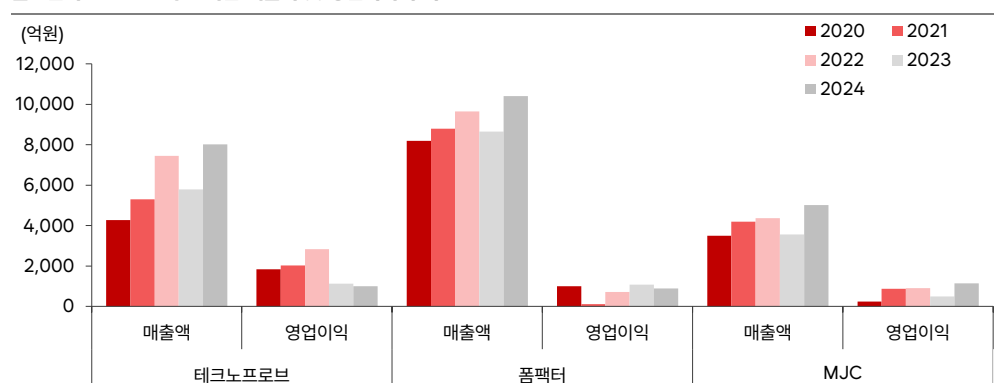
프로브카드는 크게 메인보드(PCB), STF(Space TransFormer)기판, 인터포저(interposer) 보드, 프로브핀으로 구성되어 있다. 테스터와의 연결은 인터포저(interposer) 보드가 담당하는데, 여기에는 스프링 방식의 포고핀(pogo pin)이 사용되어 테스터 인터페이스 연결 패드와 메인 PCB 간 안정적인 전기적 접속을 구현하며, STF 기판을 통해 신호를 변환/전달한다. 최종적으로 프로브핀이 반도체 웨이퍼에 직접 접촉하여 테스트를 수행한다. 상하부 스티프너(stiffener)는 전체 구조의 기계적 강성을 확보한다.

제조 측면에서 프로브카드 업체는 일부 내재화에 성공한 글로벌 업체를 제외하고 프로브핀만 전문적으로 제작하며, 기타 부품은 외주를 통해 조달하는 것으로 파악된다. 프로브핀 제조에는 대부분 MEMS(Micro Electro Mechanical System) 공정이 활용되는데, 반도체 제조 공정을 사용하기 때문에 정교한 양산이 가능하다. MEMS는 세부적으로 2D MEMS와 3D MEMS로 구분되며, 업체별로 사용하는 방식이 다르다.

글로벌 프로브카드 시장은 FormFactor(미국), Technoprobe(이탈리아), Micronics Japan Corporation(MJC, 일본)가 과점하고 있어 진입 장벽이 높다. 글로벌 프로브카드 3사의 시장점유율은 2024년 기준 약 70%로 추정된다. 비메모리는 Technoprobe, 메모리는 FormFactor와 MJC가 주력하고 있다. FormFactor는 SK하이닉스 및 마이크론을, MJC는 삼성전자를 주요 고객사로 두고 있다. 국내의 경우 비메모리는 월테크놀로지(비상장)가 있으며, 메모리는 마이크로투나노, 솔브레인, 티에스이, KI(코리아인스트루먼트, 비상장), 피엠티, AMST(비상장) 등이 있다. 진입 장벽이 높은 시장인 만큼 대부분의 레거시 제품인 NAND를 제외하고 DRAM/HBM 시장에서는 해외 업체와의 격차가 다소 존재하는 것으로 파악된다.

프로브카드는 NAND, DRAM, HBM 순서대로 기술 난이도가 높다. 프로브핀 수가 각 2~3배 이상 많기 때문이다. NAND용 프로브카드는 통상 1억 원 내외 수준에서 가격이 형성되어 있으며, HBM/DRAM용 프로브카드 ASP가 NAND 대비 2~3배 이상 높다. 글로벌 Top3 프로브카드 기업들의 합산 매출액은 2024년 전년 대비 30.2% 증가하였으며, 이는 기존 DRAM 대비 2~3배의 Probe Card가 필요한 HBM Capa. 확대에 기인한 것으로 파악된다.

글로벌 주요 프로브카드 기업 매출액 및 영업이익 추이



자료: 각 사, 한국IR협의회 기업리서치센터

파이널 테스트/테스트 소켓 산업

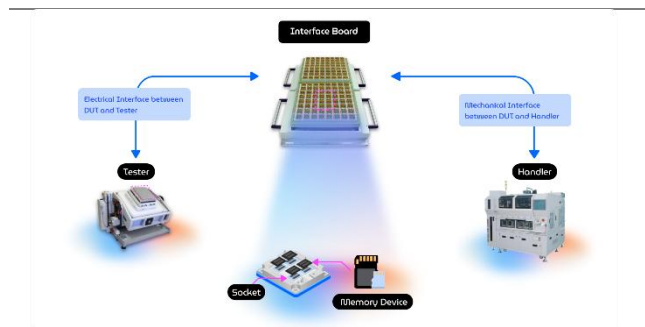
개요

웨이퍼 테스트에서 양품으로 판정된 칩에 대해서 패키징 공정을 진행한 뒤, 파이널 테스트(패키징 테스트)를 진행한다. 웨이퍼 테스트는 웨이퍼에서 동시에 여러 칩들을 테스트해야 하므로 원하는 테스트 항목을 충분히 테스트하지 못할 수도 있기 때문이다.

파이널 테스트 공정은 핸들러와 테스터의 조합으로 구성되며, Burn-in Test → Low Frequency Test → High Frequency Test 순서로 진행된다. 각 단계는 칩의 신뢰성과 성능을 단계적으로 검증하는 역할을 수행한다.

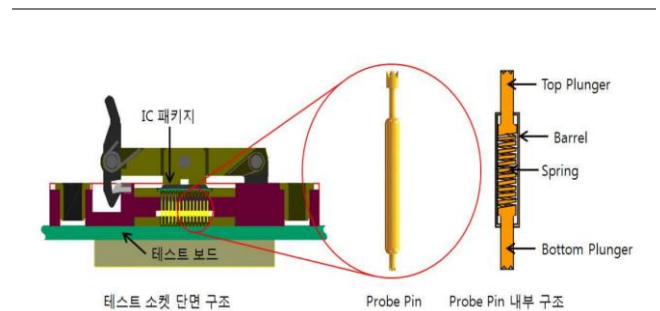
번인 테스트는 정상 동작 조건보다 높은 온도, 전압, 전류를 장시간 인가하여 초기 불량률 강제로 유발하고 선별하는 공정이다. 입출력 단자를 테스트 신호 발생회로와 연결하여 실제 동작 패턴을 시뮬레이션하며, 잠재적 결함이나 제조 공정 중 발생한 미세 손상을 조기에 검출한다. 번인을 통과한 칩은 이후 저주파 테스트(Low Frequency Test)에서 DC 특성, 기본 로직 동작, 메모리 셀 기능 등을 검증하고, 최종적으로 고주파 테스트(High Frequency Test)에서 고속 신호 전송, 타이밍 마진, 신호 무결성 등 실제 응용 환경에서의 성능을 확인함으로써 출하 품질을 완성한다. 최근 파이널 테스트 공정에서는 Burn-in Test와 Low Frequency Test를 동시에 수행할 수 있는 CLT(Chambered Low-frequency memory Tester) 장비가 도입되고 있다. 이 때, 오킨스전자와 같은 소켓 제조기업들은 각 테스트 장비에 맞는 번인 소켓과 테스트 소켓을 납품하는 구조이다.

테스트 소켓 구조



자료: TSE, 한국IR협회의 기업리서치센터

테스트 소켓 단면도



자료: 국가 R&D 연구보고서, 한국IR협회의 기업리서치센터

CLT(Chambered Low-frequency memory Tester)



자료: 엑시콘, 한국IR협회의 기업리서치센터

핸들러는 패키징이 완료된 개별 다이를 테스트 소켓으로 옮기는 역할을 하는 패키지 테스트용 장비로, 트레이에서 패키지 칩을 꺼내어 테스트 소켓에 정확히 위치시킨다. 각 테스터는 핸들러와 1:1로 페어링된다. 수많은 테스트 소켓은 테스트 보드 위에 미리 부착되어 있으며, 테스트 보드는 테스터 핸들러의 상단에 놓이게 된다. 패키지의 솔더볼이 아래쪽을 향하도록 패키지 테스트 소켓에 넣어서 소켓에 있는 핀들과 물리적으로 접촉하게 만든다.

테스트 소켓에서 사용되는 전기적 연결 방식은 S자형의 캔틸레버 (Cantilever), 수직 접촉형의 포고핀 (Pogo pin) 등이 있으며, 이 중 포고핀은 소형/고정밀/경량화의 장점으로 고주파 소자나 프로브 카드 등에 활용되기도 한다. 포고핀은 상단 오른쪽 그림과 같이 플런저, 배럴, 스프링으로 구성되며, 스프링이 외부의 수직 압축에 저항하기 때문에 접촉 패드와 플런저 사이에 안정적인 접촉이 보장된다. 테스트 소켓은 패키지와 접촉 패드를 전기적으로 연결하며, 최소한의 손상으로 안정적인 접촉을 수행하는 것이 가장 중요하다. 최근에는 반도체 미세화에 따라 스프링을 이용하는 방식인 기존의 포고핀은 접촉 영역에 대한 정밀 가공이 어려워, MEMS 포고핀 활용이 증가하고 있다.

글로벌 반도체 파이널 테스트 기업으로는 크게 7개 기업이 점유하고 있다. 테스트 소켓 기업의 경우 시장 전반에 걸쳐 기술력이 상향 평준화된 편이며, OSAT 또는 파운드리가 개별 구성 요소를 별도로 구매하거나 자체 개발하고 있다.

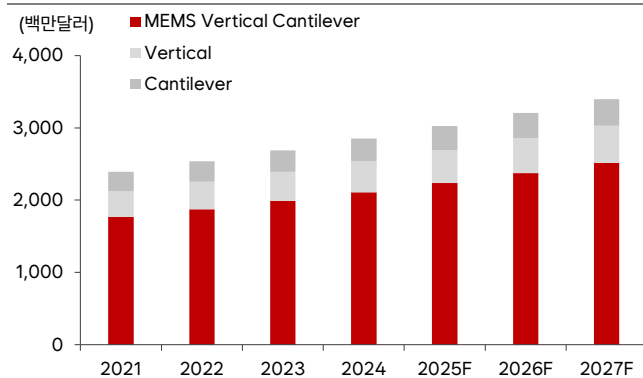
글로벌 반도체 파이널 테스트(소켓 기업) 7개사

	Cohu	리노공업	Yokowo	WinWay	ISC	Yamaichi
시장점유율	10~15%	10~15%	10~15%	8~10%	8~10%	8~10%
국가	미국	한국	일본	대만	한국	일본
주요 제품	소켓	포고핀, 소켓	포고핀, 소켓	소켓	소켓	소켓, 인터페이스 보드
기타 제품	프로브카드, 테스트 시스템	프로브카드, 배터리 테스트	커넥터, 기타 테스트 부품	시스템 레벨 테스트, 번인 소켓, 프로브카드	커넥터, 번인 테스트	커넥터, 번인 소켓, 인터페이스 보드

자료: 각 사, 언론, 한국IR협의회 기업리서치센터

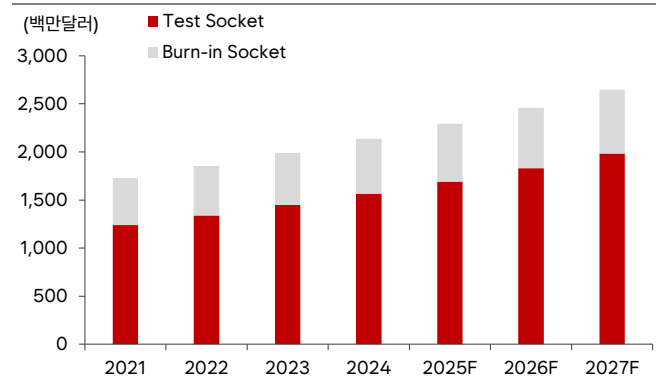
글로벌 프로브카드 시장 규모는 2024년 기준 약 29억 달러로, 테스트 소켓 시장 21억 달러 대비 약 38% 큰 규모를 형성하고 있다. 프로브카드는 웨이퍼 레벨에서 수천 개의 다이를 동시에 검사하는 부품으로, 전공정 직후 불량 칩을 조기에 선별하는 역할을 수행하기 때문에 시장 규모가 상대적으로 크다. 테스트 소켓 시장 내에서 번인 소켓은 상대적으로 시장 규모가 작고 제품군이 제한적이다. 또한, 반도체 고도화에 따라 번인 소켓의 고유 기능이었던 스트레스 테스트가 테스트 소켓 단계로 흡수되면서, 두 제품군 간 기능적 경계가 모호해지고 있다. HBM/LPDDR 등 고성능 메모리 수요 증가에 따라 고부가 소켓 수요 증가는 지속될 전망이다.

글로벌 Probe Card 시장 규모 추이 및 전망



자료: Yole, 한국IR협회의 기업리서치센터

글로벌 Socket 시장 규모 추이 및 전망



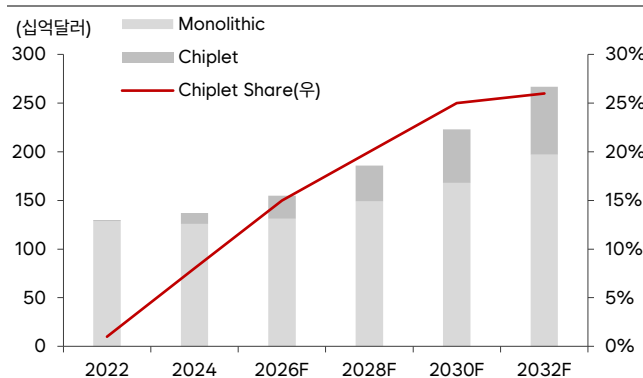
자료: Yole, 한국IR협회의 기업리서치센터

반도체 웨이퍼 테스트(프로브카드) 시장 기회 요인

AI 인프라 확장이 촉발한 메모리 수요의 구조적 전환

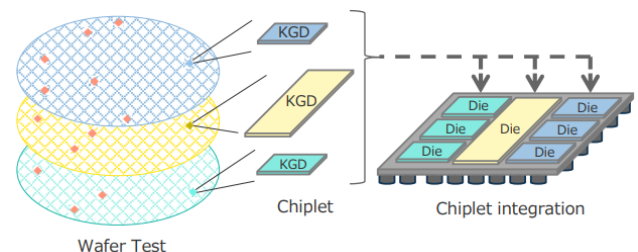
HBM 수요 확대 대응을 위한 주요 메모리 업체의 Capex 확대 및 Advanced Packaging 전환에 따른 프로브카드 시장 성장을 전망한다. HBM은 다수의 DRAM 다이가 수직으로 적층된 구조로, GPU 1개당 여러 개의 HBM이 탑재되고 각 HBM은 다시 여러 개의 DRAM 다이로 구성된다. 이에 따라 웨이퍼를 스택하기 이전 개별 DRAM 웨이퍼 테스트 수요 증가가 예상된다.

웨이퍼 아키텍처별 시장 전망



주: Monolithic Die-싱글 칩 디자인, 자료: BES, 한국IR협회의 기업리서치센터

칩렛 구조 적용에 따른 웨이퍼 테스트 기회



주: KGD-Known Good Die, 결함이 없는 양품의 다이를 의미, 자료: MJC, 한국IR협회의 기업리서치센터

HBM 적층 구조 고도화에 따른 프로브카드 ASP 증가 전망

동시에, 칩렛 기반 Advanced Packaging 전환은 프로브카드의 Test Intensity(반도체 매출 중 웨이퍼 테스트에 지출되는 비용)와 ASP를 구조적으로 상승시킬 전망이다. 특히 HBM, 2.5D/3D IC, CoWoS 등 Advanced Packaging 기술이 고도화됨에 따라 칩 간 연결을 위한 I/O bump pitch는 지속적으로 감소하는 반면 I/O 밀도는 급증하고 있어, 더욱 정밀하고 복잡한 프로브카드가 요구된다. 실제로 전체 반도체 매출 중 프로브카드에 지출되는 반도체 매출의 비중은 역사적으로 평균 약 0.4% 수준이었으나, HBM과 같은 일부 고급형, 고복잡성 제품의 경우 최고 0.8%에 이르는 것으로 추정된다.

즉, HBM과 AI 반도체 중심의 테스트 물량 급증은 시장의 양적 확대를 견인하는 동시에, Advanced Packaging 확산과 Test Intensity(전체 반도체 매출 중 웨이퍼 테스트에 지출되는 비중) 상승은 고부가가치 제품으로의 믹스 개선을 가속화하고 있다. Advanced Logic 프로브카드의 ASP는 2010년부터 2025년까지 연평균 12% 성장한 것으로 추정된다. 또한, 실제로 비메모리 웨이퍼 프로브 테스트 시장의 강자인 테크노프로브는 과거 메모리 시장의 낮은 마진율로 인해 진입을 유보했으나, 최근 메모리 칩의 복잡성 증가와 테스트 요구사항 고도화에 따라 HBM 시장 참여를 선언했다. 이는 메모리 프로브카드 시장이 기술적 난이도와 수익성 측면에서 질적 전환을 이루고 있음을 보여주는 단적인 사례다. 반도체 산업의 고성능·고집적화 추세가 구조적으로 지속되는 한, 프로브카드 시장의 성장 모멘텀은 2026년 이후에도 중장기적으로 유지될 것으로 판단된다.

1 패키지 테스트(테스트 소켓) 시장 기회 요인

Why KGD?

HBM 다이 레벨 테스트 요구되는 것은, 절단이 완료된 HBM 스택 상태에서 전수 검사를 통해 후공정 리스크 차단과 품질 보증

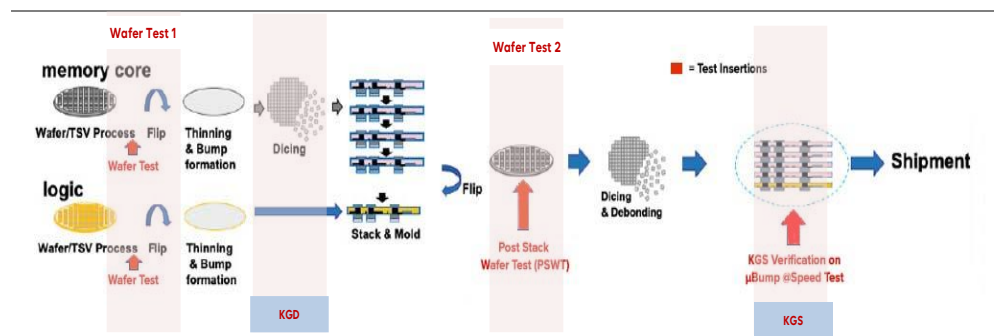
HBM 다이 레벨 테스트 시장 개화에 따른 테스트 소켓 시장 성장을 기대한다. HBM은 고가의 GPU/Logic과 2.5D 패키징으로 결합되며, 적층 후 HBM 불량 발견 시 패키지 전체를 폐기해야 하므로, 조립 직전 KGD(Known Good Die)를 확보해야 한다. 웨이퍼 테스트(EDS)는 양품이었던더라도, 다이싱(절단) 과정에서 미세 크랙(Micro-crack), 칩핑(Chipping), 소잉 분진 오염이 발생할 수 있는데, 이는 다이 레벨 테스트에서만 검출할 수 있기 때문이다. 웨이퍼 프로브카드는 구조상 극한의 온도(-45~145℃)와 고속 동작(At-speed) 테스트 동시 수행 어려움이 있을 것으로 판단되어, 이를 소켓 기반의 다이 레벨 테스트로 해결할 수 있을지 여부에 주목한다.

현재 HBM 테스트 과정은

2단계의 웨이퍼 레벨 테스트만 수행

현재까지 HBM의 테스트는 웨이퍼 레벨의 테스트 위주로 진행되며, 크게 두 번의 웨이퍼 테스트를 거친다. 첫번째 단계는 적층되지 않은 HBM 웨이퍼를 테스트해 적층할만한 양품의 다이를 선별하는 것이고(Wafer Test1), 두번째 단계는 선별된 다이를 로직 웨이퍼 위에 Chip to Wafer 적층한 후 해당 HBM 웨이퍼의 다이를 중 양품의 다이를 선별하는 과정(Wafer Test2)이다.

HBM Test Flow



자료: Formfactor, 한국IR협의회 기업리서치센터

HBM 스택 자체가

고성능 칩셋화되는 중

HBM의 1) 단수는 지속적으로 증가하여 8단 → 12단 → 16단으로 늘어나고, 2) HBM Logic Base Die 에는 다양한 로직들이 추가되면서 고급화되고 있다. 특히 HBM3/3E에서는 Bare Die가 20nm급 Planar CMOS로 추정되나, HBM4 이후 Logic Base Die가 4nm급 FinFET으로 미세화되고 있다. 또한, HBM4의 경우 최하단 Logic Base Die의 변화로 추가적인 통신 등 로직 기능들이 HBM으로 내재화되었다. 삼성전자는 자체 파운드리를 통해 Logic Base Die를 제조하

고, 하이닉스와 마이크론은 TSMC의 파운드리에서 제조하고 있다. 즉, 삼성전자의 경우 TSMC에 HBM을 전달하는 과정에서 더 우수한 품질을 달성해야 할 것으로 예상된다.

HBM 세대 및 공급사별 DRAM/Logic Base Die 기술

	HBM3E	HBM4	HBM4E
Dram process			
SK Hynix	1b nm	1b nm	1c nm
Samsung	1a nm	1c nm	1c nm
Micron	1β nm	1β nm	1γ nm
Logic base die process			
SK Hynix	DRAM	TSMC(12 nm)	TSMC N3
Samsung	DRAM	Samsung Foundry(4nm)	Samsung Foundry or TSMC
Micron	DRAM	DRAM(2z nm)	TSMC

주: 자료: 각 사, 한국IR협회의 기업리서치센터

HBM 다이 레벨 테스트의 방법

적층된 상태에서 다이(Die)를 바로 검사하는 것은 쉽지 않다. 절단된 HBM 스택은 두께가 얇고 측면이 노출된 실리콘 구조로 매우 취약하기 때문에, 핸들러가 직접 파지할 경우 물리적 손상이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 다이 캐리어(Die Carrier)가 필요하다. 다이 캐리어는 플라스틱 또는 금속 복합 소재의 하우징 구조로 칩을 감싸며, 측면 보호(Anti-Chipping), 하단 범프 보호, 열팽창에 따른 워페이징(휨)을 제어한다. 다이 레벨 테스트는 HBM 스택을 다이 캐리어에 로딩한 후, 비전 시스템으로 5μm 이내 정렬을 수행하고, 테스트 챔버로 이송하여 소켓에 압착한 뒤 고온·저온 환경에서 전기적 특성을 검사하는 공정이다. 다이 캐리어 개발에는 소잉 공차를 흡수하는 마이크로미터 단위의 초정밀 사출 및 가공 기술, 히터·쿨러의 직접 전도 방식을 구현하는 능동 열 전달 구조, 그리고 외부 파티클 침투를 차단하는 먼지 유입 방지 구조가 핵심이다.

HBM 테스트 소켓의 역할

다이 캐리어가 HBM 스택을 테스트 위치로 이송하면, 실제 전기적 신호 연결은 테스트 소켓이 담당한다. 그러나 HBM의 초미세 범프 피치는 기존 패키지 테스트 소켓으로는 대응이 불가능하며, 웨이퍼 레벨 테스트에 준하는 정밀도가 요구된다. 일반적인 패키지 테스트 소켓은 기계적으로 가공된 포고핀을 사용하지만, HBM의 범프 피치는 65μm 이하로 좁아 한계가 있다. 이에 따라 웨이퍼 테스트용 프로브카드에 사용되던 초정밀 MEMS 핀을 소켓 형태로 적용하는 방식이 필요하다.

반도체 후공정 테스트 Supply Chain

기업명	국가	시가총액	EPS Growth(%)	P/E(x)	P/B(x)	ROE(%)
OSAT						
ASE Industrial	대만	1,263.0	60.7	21.2	3.4	16.9
King Yuan Electronics	대만	343.0	10.3	28.6	6.8	26.0
Amkor Technologh	미국	10,943.3	-12.6	26.2	2.3	9.3
JCET Group	중국	11,512.7	0.0	32.9	2.6	7.4
TongFu Microelectronics Co Ltd	중국	72.4	33.3	42.5	4.3	9.1
하나마이크론	한국	2,267.2	156.8	24.7	4.6	21.4
SFA 반도체	한국	1,143.0	-214.1	46.3	2.3	4.9
OSAT Sector Average			4.9	31.8	3.7	13.6
Tester						
Advantest	일본	18,578.9	75.0	44.5	18.9	48.9
Teradyne Inc	미국	42.5	81.8	43.8	12.32	32.2
네오센	한국	740.5	317.6	22.2	4.9	24.5
Tester Sector Average			158.1	36.8	12.0	35.2
Handler						
Cohu Inc	미국	1.4	20.0	44.6	1.82	2.5
테크윙	한국	1,663.7	577.2	33.9	5.7	20.0
Handler Sector Average			298.6	39.2	3.8	11.2
Probe Card						
FormFactor Inc	미국	6.5	43.1	45.2	5.7	11.9
Micronics Japan Co Ltd	일본	349.4	42.2	25.3	4.8	27.3
Technoprobe SpA	이탈리아	11,846.2	70.6	60.7	6.8	12.0
티에스이	한국	956.8	-56.2	2.3	2.3	12.5
Probe Card Sector Average			24.9	33.3	4.9	15.9
Test Socket						
리노공업	한국	7,293.5	19.9	42.4	8.6	22.1
ISC	한국	3,154.1	44.6	40.4	5.1	13.8
Winway Technology Co Ltd	대만	159.5	61.4	59.8	22.4	37.3
Enplas	일본	120.2	-3.8	26.0	1.86	7.4
오킨스전자	한국	306.7	97.5	19.2	5.9	30.9
마이크로컨택솔(MCS)	한국	169.6	6.80	10.7	1.8	18.2
Test Socket Sector Average			37.7	33.1	7.6	21.6

주: 2월 2일 종가 기준, 2026F 추정치 적용. 시가총액 단위는 해외기업 십억달러, 국내기업 십억원. 오킨스전자는 당사 추정치 사용

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터



투자포인트

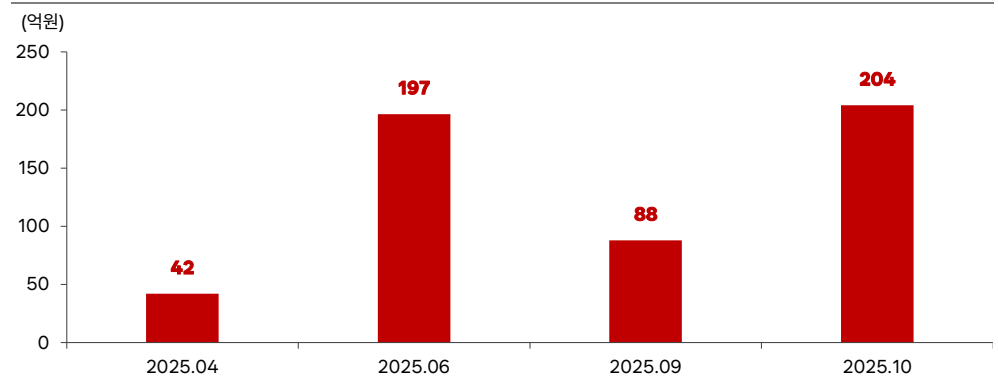
1 고효율 CLT 장비용 소켓 수요 증가 수혜 기대

**CLT(Chambered Low-frequency memory Tester)향
소켓/커넥터 매출 증가 전망**

오킨스전자의 첫 번째 투자포인트는 고효율 CLT(Chambered Low-frequency memory Tester)용 소켓을 공급하며 수혜를 입는다는 것이다. CLT는 DRAM 컴포넌트 안정성 테스트와 CXL, PCIe 5/6세대 등 고속 인터페이스 테스트를 동시에 수행하는 장비로, -20°C~150°C의 극한 환경을 조성하며, 기존 테스터 대비 약 20배 수준의 병렬 테스트가 가능하다.

오킨스전자의 최종 고객사인 삼성전자는 기존 외산 테스트 장비의 한계를 극복하기 위해 국내 테스트 장비업체와 협력하여 CLT를 개발했으며, 여기에 엑시콘이 주요 공급업체로 선정되었다. 이 때, 동사는 CLT에 사용되는 소켓과 커넥터를 단독 공급하고 있다. 다만 동사 공시상 CLT용 부품(소켓, 커넥터) 매출은 BITS 사업부 및 기타 사업부에 포함되어 있어, CLT향 매출을 별도로 분리해 직접 확인하기는 어렵다. 그러나, 반도체 밸류체인 내에서 CLT 관련 시장 규모의 확대를 간접적으로 확인할 수 있는 방법이 있는데, 이는 엑시콘의 CLT 수주액을 확인하는 것이다. 엑시콘은 2025년 4월 수주를 시작으로, 현재까지 CLT 관련 누적 수주액은 약 531억 원이다. 이를 감안했을 때, 오킨스전자의 CLT향 소켓 매출액은 연간 기준 최소한 수십억 원일 것으로 추정되고, CLT 장비용으로 소켓뿐만 아니라 커넥터도 공급한다는 것을 감안하면 연간 기준 CLT향 매출이 최소한 100억 원을 상회할 것으로 예상된다.

엑시콘의 CLT 수주액



자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

국내 메모리 테스트/핸들러 장비 업체 공급망

기업명	주요 제품	주요 고객사
와이씨	메모리 웨이퍼 및 패키지 테스트 장비(DRAM, NAND, HBM)	삼성전자
디아이	메모리 웨이퍼 및 패키지 테스트 장비(DRAM, NAND, HBM)	삼성전자, SK 하이닉스
유니테스트	메모리 웨이퍼 및 패키지 테스트 장비(DRAM, NAND)	SK 하이닉스, 마이크론, CXMT
엑시콘	메모리/로직 패키지 테스트 장비(DRAM, NAND, SoC)	삼성전자
네오셈	메모리 패키지 테스트 장비(DRAM/NAND, SSD)	삼성전자, SK 하이닉스
테크윙	테스트 핸들러	삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론

자료: 언론 종합, 한국IR협의회 기업리서치센터

차세대 AI 플랫폼은 LPDDR 기반 SOCAMM2 채택 본격화

AI 서버용 HBM/LPDDR 수요 증가는 CLT 설비 교체 및 투자를 가속화할 전망이다. 2H26F 출시 예정인 NVIDIA의 VR200은 플랫폼은 기존의 납땜형 방식에서 벗어나 교체 가능한 모듈형인 LPCAMM2 규격을 채택하며, CPU당 1.5TB의 대용량 LPDDR5X를 탑재할 것으로 보인다. 최근 몇 년간 DDR4 구간에서는 번인 수요가 약했고 성장률도 낮았으나, DDR5 및 LPDDR5, AI 서버용 수요 확대에 따라 번인 수요가 재차 증가하고 있다. 삼성전자는 P4 라인의 클린룸 공간 활용 유연성을 바탕으로 기존 DDR 배치를 가속화할 것으로 예상된다. HBM과 DDR을 합산하여, 삼성전자는 2026년 약 70k wpm의 신규 Capa.를 증설하고 2027년에는 추가로 약 80k wpm의 Capa.를 확충할 계획인 것으로 파악된다. 이에 따라 삼성전자의 DDR 웨이퍼 및 패키지 테스트 지출 역시 전년 대비 증가세를 보일 것으로 판단된다.

서버급 신뢰성 요구에 따른 LPDDR 번인 테스트 수요 증가

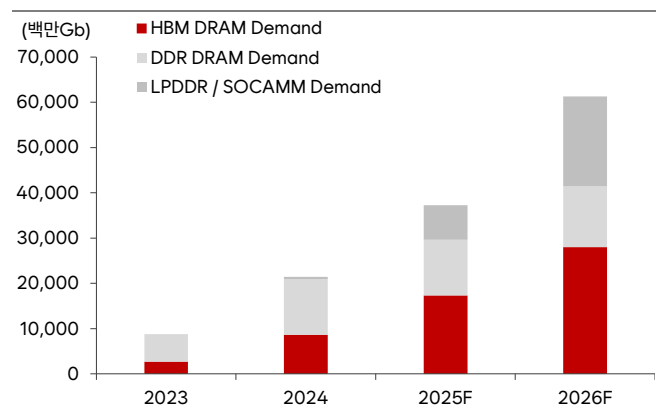
특히 LPDDR의 AI 서버 채용 증가는 번인 테스트 수요를 구조적으로 증가시킬 전망이다. LPDDR이 AI 서버에 채용될 경우, 기존 모바일과 달리 테스트 요구사항이 달라진다. LPDDR(Low Power Double Data Rate)은 고속·저전력 특성을 갖추고 있음에도 서버급 운용에서 필수적인 오류 정정 측면이 상대적으로 취약해 데이터센터 채용이 제한적이었다. 그러나 이후 SOCAMM(System on Chip Advanced Memory Module) 개념의 등장으로, LPDDR을 모듈 형태로 구성해 유연한 교체·업그레이드를 가능하게 하는 동시에, HBM 대비 낮은 비용으로 우수한 전력 효율과 높은 대역폭을 제공할 수 있어 서버 채용이 확대되고 있다. 기존 모바일용 LPDDR은 경제성을 이유로 번인 테스트를 생략하는 경우가 많았다. 그러나 AI 데이터센터는 24시간 무중단 가동이 필수이며, 가혹한 환경에서의 수명 보증이 요구된다. 이에 따라 번인 스트레스 테스트는 선택이 아닌 필수 항목으로 전환되었다. 이에 따라 저전력 메모리 특성을 반영한 고사양 테스트 인프라에 대한 수요 증가를 전망한다.

AI 서버 세대별 HBM 및 LPDDR/SOCAMM 구성

	GB300 NVL72 (2H25)	VR200 NVL144(2H26F)	VR300 NVL576(2H27F)
HBM			
HBM Generation	HBM3E 12Hi (36 x 576GB)	HBM4 12Hi (36 x 576GB)	HBM4E 16Hi (144 x 1TB)
Content Per Rack	= 20.3TB	= 20.3TB	= 144TB
LPDDR / SOCAMM			
LPDDR / SOCAMM	LPDDR5X (4 x 36 x 128GB)	SOCAMM2 (8 x 36 x 192GB)	SOCAMM2 (8 x 144 x 192GB)
Content Per Rack	= 18TB	= 54TB	= 216TB
Total Fast Memory (TB)	38.3TB	74.3TB	360TB
Official NVDA Specs	40TB	75TB	365TB

자료: 언론 종합, 한국IR협회의 기업리서치센터

AI 서버용 메모리 수요 추이 및 전망



자료: Gartner, 한국IR협회의 기업리서치센터

번인 소켓 단가 상승 예상

한편, 차세대 메모리 번인 테스트에서는 소켓 폼팩터 변화가 진행 중이다. LPDDR 메모리는 기존 DDR 대비 I/O 단자 수가 많고 단자 간격이 0.3mm 수준까지 좁아졌으며, 데이터 전송 속도 또한 급격히 증가하고 있다. 전통적으로 사용되어 온 핀치(Pinch) 방식 소켓은 0.4mm 이상의 단자 간격을 가진 메모리에 적합하며, 좌우에서 집게처럼 솔더볼을 협지하여 전기적 접촉을 구현한다. 그러나 단자 간격이 0.5mm 이하로 축소되고 신호 전송 속도가 고도화된 제품군에서는 보우(Bow) 방식으로 전환되고 있다. 보우 방식 소켓은 제조 과정에서 숙련된 인력의 정밀 조립 공정이 추가로 투입되어 핀치 방식 대비 평균 판매가격이 3배 수준으로, 수익성 개선도 동반될 전망이다.

AI향 메모리 수요로 인한 전사적 매출 증가 예상

오킨스전자의 두 번째 투자포인트는 AI향 메모리 수요가 본업이 아니었던 분야에서의 매출 성장을 견인한다는 것이다. 동사의 설립 당시 본업은 메모리 번인 소켓이고, 본업에서도 AI향 메모리 수요 증가에 따른 수혜가 존재하나, 매출 성장 속도가 빠를 것으로 기대되는 분야는 번인 소켓이 아닌 1) AI 메모리향 다이 캐리어 테스트 소켓, 2) MEK향 포고핀, 3) 마그네틱 콜렛이다.

AI 메모리향 다이 캐리어 테스트 소켓 매출 증가 기대

1) AI 메모리향 다이 캐리어 테스트 소켓

메모리 반도체는 원래 웨이퍼 레벨 테스트와 칩 레벨 파이널 테스트를 모두 필요로 한다. 그러나, AI 메모리 반도체의 경우 적층 구조가 복잡해 최근까지 웨이퍼 레벨 테스트 위주로 진행되었다. 적층된 상태에서 칩 레벨 다이(Die)를 바로 검사하는 것이 쉽지 않았고, 그러다 보니 수율 개선이 어려웠다. AI 메모리 반도체 수요가 폭발적으로 성장하던 시기에는 수율이 낮더라도 기존 DRAM 대비 높은 가격에 판매가 가능했으나, 최근에는 오히려 AI 메모리 반도체보다 레거시 메모리 반도체의 수요 및 마진이 급증하고 있어 결론적으로 AI 메모리 반도체 공정에서 수율 개선이 요구되는 상황이다.

이러한 상황에 대응하기 위해 업계에서는 AI 메모리 반도체 스택을 절단한 후, 개별 다이 레벨 테스트를 수행하는 것에 대한 필요성이 제기되고 있다. 개별 다이 레벨 테스트를 위해서는 다이 캐리어가 필요하다. 다이 캐리어는 하우징 구조로 개별 칩을 감싸고 보호하며 휨 현상을 제어한다. 다이 캐리어의 활약에 힘입어 다이 레벨 테스트가 전개되면, 개별 다이는 소켓에 압착된 뒤 고온/저온 환경에서 전기적 특성의 확인을 거친다.

AI 메모리 시장 대응 차원에서 오킨스전자의 다이 캐리어 테스트 소켓 매출 증가가 기대된다. 테스트 소켓에서는 원래 기계적으로 가공된 핀이 사용되나, AI 메모리 반도체의 경우 연결단자(범프) 피치가 $65\mu\text{m}$ 로 좁아 기존 형태의 핀이 적합하지 않다. 따라서 더욱 정밀한 MEMS 핀이 소켓 내부의 접촉핀으로 사용된다. 동사는 MEMS(Micro Electro-Mechanical Systems) 사업부를 별도 운영하여 반도체 미세가공 기술을 활용한 MEMS 핀 자체 설계·생산 역량을 확보하고 있으며, 다양한 형태의 MEMS 핀 라인업을 보유하고 있다. 현재 해당 기술을 바탕으로 주요 고객사향 AI 메모리 테스트 소켓 킴 테스트 중인 것으로 파악된다. AI향 메모리 테스트 소켓은 주요 고객사의 대규모 증설 계획을 고려할 때 연평균 24~30% 이상의 고성장이 예상되는 시장인 점을 감안하면, 동사의 AI 메모리향 테스트 소켓 매출액은 기존 테스트 소켓 매출에 통상 20~30% 수준의 추가 성장이 기대된다.

포고핀 수요 증가 전망

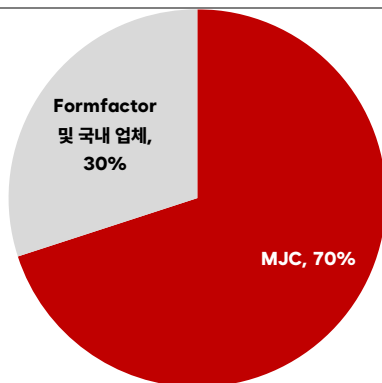
2) MEK향 포고핀

MEK는 프로브카드 업체인 MJC의 한국 법인이다. MJC는 프로브카드를 삼성전자에 납품하고 있으며, 특히 DRAM용 프로브카드 분야에서는 전 세계 1위로 알려져 있다. 프로브카드는 웨이퍼와 검사장비를 연결하는 과정에서 인터포저(중간 연결부)를 거치는데, 이때 전기 신호를 안정적으로 전달하기 위해 포고핀이 사용된다. 오킨스전자는 이에 적합한 포고핀을 MEK에 공급하고 있다. 프로브카드는 신속한 C/S를 위해 웨이퍼 생산 시설 인근에 위치해야 하는 특성을 가지고 있으며, MEK는 국내 메모리 고객사의 현지 대응 수요에 맞춰 생산 능력을 지속 확대해왔다.

오킨스전자는 크게 세 가지 우위를 바탕으로 프로브카드용 포고핀 경쟁력을 강화하고 있다. 첫째, 자동화 설비 기반 생

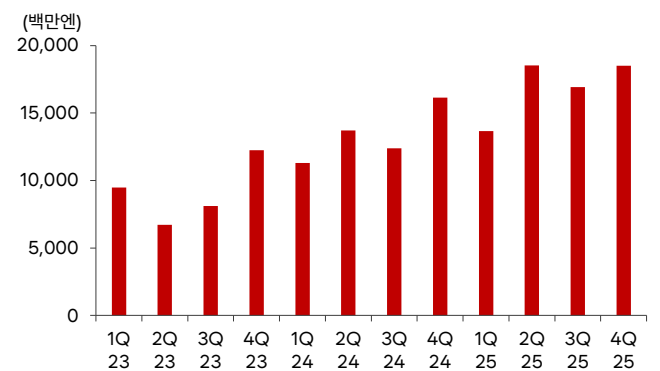
산으로 수작업 비중이 높은 경쟁사 대비 생산 속도와 정밀도에서 우위를 확보했다. 둘째, 경쟁사 대비 약 50% 수준의 단가로 시장에 진입해 고객사 입장에서 원가 경쟁력이 우수하다. 셋째, 포고핀의 개별 전기적 특성 데이터를 축적하고 딥러닝을 활용해 편차 및 불량 패턴을 분석하여 고객사에 제공함으로써 수율 관리와 문제 해결에 기여하고 있다. 또한 동사는 MEK 외에 추가적인 고객사 확보를 위해 노력하고 있다. 대표적으로 2025년 10월, 프로브카드 업계에서 잘 알려진 KI(Korea Instrument)의 쿼 테스트를 통과했다. 아울러, 해외 프로브카드 회사인 폼팩터(FormFactor), 테크노프로브(Technoprobe)와도 납품을 협의중인 것으로 파악된다. 이처럼 프로브카드 고객사 포트폴리오 확대에 따른 포고핀 매출의 지속 확대가 기대된다.

삼성전자 내 프로브카드 점유율



주: 2024년 기준, 점유율은 매출 기준 당사 추정, 자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

MJC 프로브카드 분기별 매출액 추이



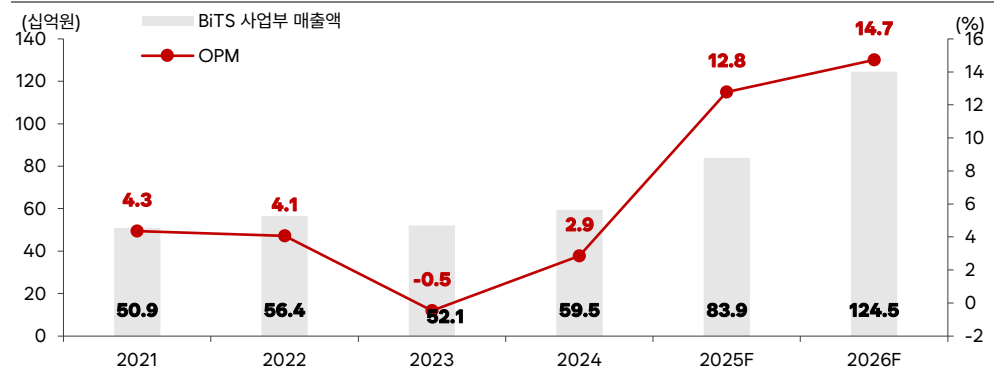
자료: MJC, 한국IR협회의 기업리서치센터

HBM 3사항 마그네틱 콜렛 매출 증가 전망

3) HBM 3사항 마그네틱 콜렛

마지막으로, 마그네틱 콜렛의 매출 성장도 기대된다. 마그네틱 콜렛은 반도체 패키징 공정에서 다이를 집어 올리거나 (Pick & Place) 적층(본딩)하는 과정에 쓰이는 핵심 소모성 픽업 툴로, 일정 횟수 사용 후 교체가 필요해 가동률·증설에 연동된다. 특히 최근 오킨스전자는 HBM용 마그네틱 콜렛을 글로벌 메모리 3사에 모두 공급하게 되어 고객사 확대에 따른 물량 증가가 기대된다. 또한, HBM 공정은 일반 DRAM 대비 높은 정밀도가 요구되는 제품으로 매출 및 이익 기여도 모두 높을 것으로 전망한다.

오킨스전자 BITS사업부 매출액 및 영업이익 전망



자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터



실적 추이 및 전망

1 실적 변화를 확인한 2025년

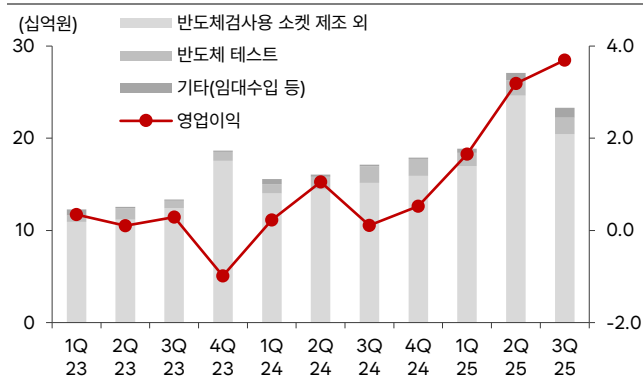
2025년 매출액, 영업이익
944억 원(+41.5% YoY),
121억 원(+536.3% YoY) 기록

2025년 동사는 매출액 944억 원(+41.5% YoY), 영업이익 121억 원(+536.3% YoY)을 기록하며 큰 폭의 실적 개선을 달성했다(30% 변동 공시 기준). 사업부별로 살펴보면, BiTS 사업부는 전년 대비 40.9% 증가한 839억 원을 전망한다. 삼성전자향 LPDDR5 번인 소켓 수주 및 중국 CXMT향 번인 소켓 매출 회복이 주요한 성장 요인이었다. 여기에 더해, 포고핀의 경우 원가 경쟁력을 바탕으로 MEK 내 점유율 증가에 따라 관련 매출액이 기존 대비 약 2배 증가한 것으로 추정된다. 또한, 기타 부문 매출은 주로 CLT향 커넥터 매출 확대에 기인한 것으로 파악된다.

영업이익의 경우 전년 대비 536.3% 증가한 121억 원을 기록했다. 2024년에는 포고핀 및 테스트 용역 비즈니스 확대를 위한 선형 투자로 손익이 일시적으로 훼손되었으며, 과거 동사는 매출 증가에도 불구하고 비용 통제가 원활하지 않아 이익률 개선이 어려웠다. 그러나 2025년 들어 본격적인 비용 통제가 진행되면서 원가율과 판매관리비율이 동반 하락하는 흐름을 보이고 있다. 특히 매출 증가 대비 급여비율과 감가상각비율이 하락하면서 고정비 레버리지 효과가 본격화되고 있는 점이 긍정적이다.

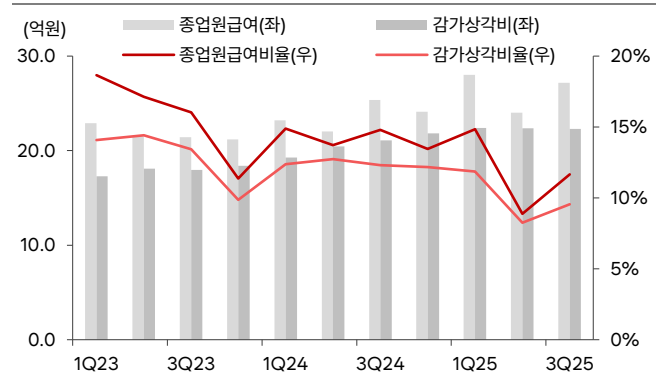
매출원가율의 경우, 전년 79.3% 대비 6.5%p 감소한 72.8%를 예상한다. 실제로 3Q25 누적 기준 사업보고서 상 성격별 비용 내역을 살펴보면, 3Q25누적 성격별 판매관리비 비율은 전년 34.8%에서 28.3%로 11%p 개선되었다. 구체적으로 종업원급여는 79억 원(+12.2% YoY), 감가상각비 67억 원(+10.2% YoY)을 기록했으나, 3Q25 누적 매출 증가율(+42.0% YoY)을 크게 하회했다. 결론적으로 고마진 메모리 소켓 및 포고핀 매출 증가에 따른 제품 믹스 개선과 고정비 레버리지 효과에 따라 영업이익률은 전년 대비 9.9%p 상승한 12.8%를 기록했다.

오킨스전자 부문별/분기별 실적 추이



자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

오킨스전자 분기별 주요 고정비 추이



자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

AI향 메모리 수요 증가에 따른 실적 확대 기대되는 2026년

2026년 매출액, 영업이익
1,405억 원(+48.9% YoY),
207억 원(+71.6% YoY) 전망

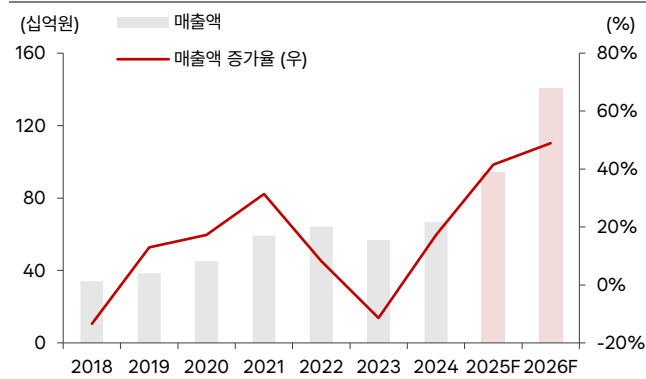
2026년 매출액은 1,405억 원(+48.9% YoY), 영업이익은 207억 원(+71.6% YoY)으로 사상 최대 실적을 전망한다.

1) BITS 사업부의 경우 전년 대비 48.9% 증가한 1,245억 원을 전망한다. 먼저 번인 소켓은 주요 고객사의 CLT 장비 교체 수요에 따른 매출 증가가 이어질 전망이다. 동사는 CLT의 소켓/커넥터를 단독 납품하고 있으며, CLT 장비를 생산하는 국내 장비사향 납품도 병행하고 있다. 특히 엑시콘의 CLT 누적 수주액은 약 531억 원으로 확인되며, 이를 감안하면 CLT 설치 대수 확대에 연동된 동사 매출이 연간 최소 100억 원을 상회할 것으로 예상된다. 테스트 소켓의 경우, 다 이싱 후 개별 다이에 대한 전수 테스트 수요에 맞춰 주요 고객사의 AI향 테스트 소켓의 쉘 테스트를 진행 중이며, 양산 적용이 확대될 경우 2026년 동사의 테스트 소켓 매출은 전년 대비 약 50% 수준의 성장이 가능하다고 판단한다. 2026년 마그네틱 콜렛 매출은 전년 대비 약 54% 성장이 전망된다. 마그네틱 콜렛은 후공정(다이 핸들링/다이 어태치) 장비에 장착되는 소모성 부품으로, 통상 3~6개월마다 교체 수요가 발생한다. 동사는 HBM 주요 3사를 고객사로 모두 확보하고 있어, HBM 가동률 상승에 따른 교체 빈도 증가가 전망된다. 2026년 포고핀 매출은 MEK 이외의 글로벌 주요 프로브카드 기업으로의 고객사 확대에 따라 전년 대비 25%의 성장을 전망한다. 웨이퍼 테스트 물량이 증가할수록 프로브카드의 유지·교체 수요가 증가하며, 기존 MEK향 매출 증가뿐 아니라, KI, 테크노프로브 등 글로벌 주요 프로브카드사로의 납품이 본격화될 경우 매출의 추가 업사이드 요소가 있다고 판단한다.

2) 반도체 테스트 사업부의 경우 전년 대비 9.1% 증가한 60억 원을 전망한다. 전기차/하이브리드 확산으로 SiC MOSFET 등 차량용 전력반도체의 탑재량이 증가하면서, 고전압·고온 환경에서의 전기적 특성/신뢰성 테스트 수요가 구조적으로 확대되고 있기 때문이다. 최근 신규 전력반도체 고객사 쉘 테스트 완료에 따라 2026년부터 실적 기여가 본격화될 것으로 판단한다.

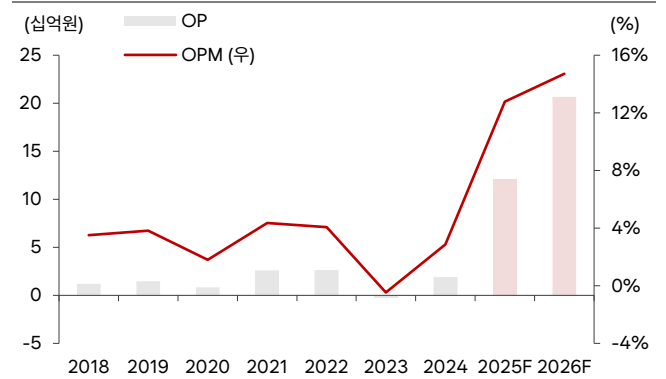
3) 기타 사업부의 경우 CLT향 매출 증가 효과를 반영해 전년 대비 2배 증가한 100억 원으로 추정하였다. CLT 전환이 진행될수록 장비 인터페이스 관련 부품(커넥터 등)의 탑재가 확대되는 구조이며, 엑시콘 이외의 국내 반도체 테스트 장비 업체의 경우도 기존 외산 커넥터 대신 동사의 커넥터를 사용하여 납품하고 있는 것으로 파악된다. 종합적으로 고마진 매출 비중 확대와 판관비율 안정화를 예상함에 따라 OPM 14.7%(+1.9%p YoY)를 전망한다.

오킨스전자 매출액 및 매출액 증가율 추이



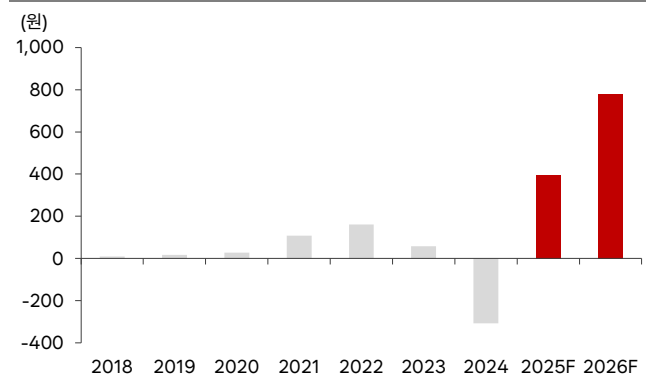
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

오킨스전자 영업이익 및 영업이익률 추이



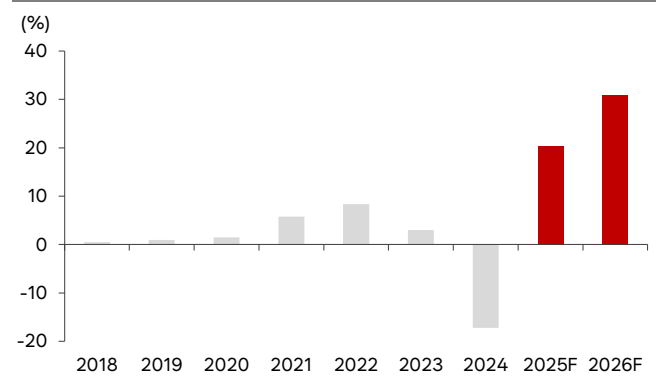
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

오킨스전자 EPS 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

오킨스전자 ROE 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

오킨스전자 부문별 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	2023	2024	2025F	2026F
매출액	12.3	12.6	13.4	18.6	15.6	16.1	17.1	17.9	18.9	27.1	23.3	56.9	66.7	94.4	140.5
BiTS(테스트 소켓 외)	10.9	11.2	12.4	17.6	14.0	14.4	15.1	15.9	17.0	24.6	20.4	52.1	59.5	83.9	124.5
반도체 테스트	0.7	1.2	0.8	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	1.5	1.6	1.8	3.7	6.0	5.5	6.0
기타	0.7	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.2	0.1	0.5	0.8	1.1	1.1	1.1	5.0	10.0
영업이익	0.3	0.1	0.3	-1.0	0.2	1.0	0.1	0.5	1.7	3.2	3.7	-0.3	1.9	12.1	20.7
지배주주순이익	0.2	-0.9	0.1	1.6	-0.6	-0.5	-1.0	-3.2	0.7	2.9	0.4	1.0	-5.4	8.1	16.0
Margin(%)															
영업이익률	2.8	0.8	2.1	-5.3	1.4	6.5	0.6	2.9	8.8	11.8	15.8	-0.5	2.9	12.8	14.7
지배주주순이익률	1.6	-7.0	0.5	8.8	-4.1	-3.3	-6.0	-18.1	3.7	10.8	1.6	1.8	-8.1	8.6	11.4
YoY Growth(%)															
매출액	-16.7	-33.4	-13.8	23.7	26.9	27.9	28.2	-4.0	21.2	68.5	36.1	-11.4	17.3	41.5	48.9
BiTS(테스트 소켓 외)	-12.9	-33.7	-8.3	30.4	28.3	29.1	21.8	-9.2	20.9	70.7	35.0	-7.7	14.3	40.9	48.5
반도체 테스트	-47.0	23.7	-39.7	-6.0	43.4	12.7	131.3	90.6	46.5	17.9	0.5	-20.7	64.0	-9.0	9.1
기타												-65.2	2.5	349.2	100.0
영업이익	-50.7	-93.7	-12.9	적지	-35.0	951.9	-62.0	흑전	642.2	203.5	3,307.9	적전	흑전	536.3	71.6
지배주주순이익	-37.5	적전	-63.9	44.3	적전	적지	적전	적전	흑전	흑전	흑전	-64.1	적전	흑전	99.0
QoQ Growth(%)															
매출액	-18.6	2.3	6.3	39.6	-16.4	3.1	6.6	4.5	5.5	43.4	-13.9				
BiTS(테스트 소켓 외)	-18.9	2.3	11.2	41.3	-20.1	3.0	4.9	5.2	6.4	45.4	-17.1				
반도체 테스트	-31.4	76.0	-36.9	23.6	4.6	38.3	29.4	1.8	-19.6	11.3	10.3				
기타	10.7	-77.2	0.7	-11.3	319.5	-57.3	-23.5	-25.8	236.3	75.3	34.0				
영업이익	흑전	-70.9	186.0	적전	흑전	371.2	-89.7	382.7	216.1	92.7	15.9				
지배주주순이익	-83.3	적전	흑전	2,461.3	적전	적지	적지	적지	흑전	317.2	-87.3				

자료: FnGuide QuantilWise, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation

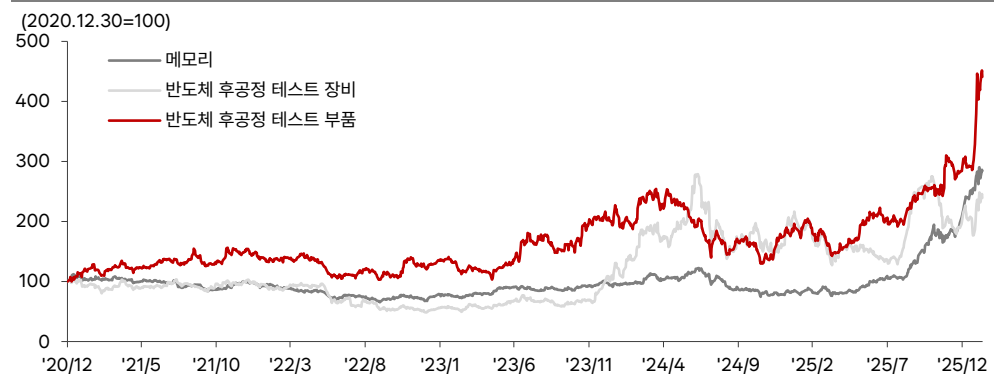
1 국내 메모리 테스트 업체의 밸류에이션 확대 기대

반도체 폼팩터 변화는
후공정 테스트 장비·부품 업체들의
연구개발 증가에 따른 단가
상승으로 이어짐

반도체 테스트 난이도 상승은 테스트 장비·부품 업체들의 연구개발 비용 증가 → 단가 상승으로 이어진다. 반도체 기술이 고도화될수록 테스트 공정의 난이도는 상승한다. 전송 속도가 빨라지면 더 높은 주파수 대역에서의 신호 무결성 (Signal Integrity) 검증이 필요해지고, 적층 단수가 증가하면 더 많은 I/O 핀을 동시에 테스트해야 하며, 미세 피치가 요구되면 접촉 정밀도가 극도로 높아져야 하기 때문이다.

2H23 이후 생성형 AI가 촉발한 반도체 수요 급증은 파운드리향 테스트 기회 증가와 메모리 부문의 DDR, GDDR, LPDDR 세대 전환에 따른 반도체 후공정 테스트 장비/부품 기업들의 주가 상승으로 이어졌다. 생성형 AI의 확산은 AI 가속기(GPU, TPU, NPU) 테스트 난이도 상승을 초래했고 이는 크게 두 가지 경로로 테스트 산업의 헤자로 이어졌다. 첫째, HBM 수요 증가에 따른 테스트 물량 확대로 적층 전 DRAM 웨이퍼 테스트 수요와 ASP 상승이 동반되었다. 둘째, AI 서버 및 데이터센터 확장에 따른 고사양 메모리 소켓 수요 증가이다. 향후 HBM뿐 아니라 서버용 LPDDR5, AI 노트북용 LPDDR5X, GPU용 GDDR7 등 차세대 고부가 메모리로의 전환이 가속화되고 있으며 이는 테스트 장비의 대규모 교체 수요와 테스트 부품의 매출 확대로 이어질 전망이다.

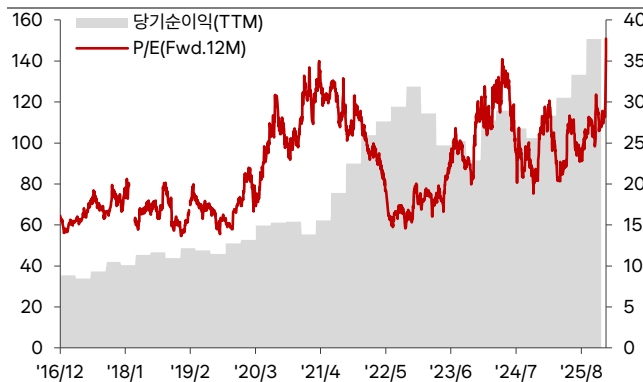
국내 반도체 후공정 테스트 장비 및 부품 기업 주가 추이



주: 1) 메모리-삼성전자, SK하이닉스, 2) 반도체 후공정 테스트 장비-엑시온, 네오센, 테크윙, 유니테스트, 3) 반도체 후공정 테스트 부품-리노공업, ISC, 오킨스전자, 마이 크로컨텍스트, 티에프이, 자료: FnGuide Quantwise, 한국IR협의회 기업리서치센터

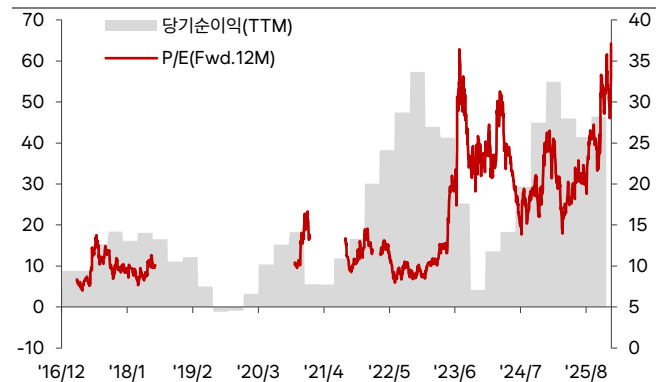
국내 반도체 테스트 부품 기업들은 실제로 새로운 시장 기회가 열릴 때 마다 실적으로 증명해왔고 그 이전에 주가가 이를 반영해왔다. HBM 시장 개화 시점 이후 테스트 소켓 기업들의 밸류에이션 확대는 주로 AI GPU 등 비메모리 반도체 수요 증가에 기인했다. 대표적으로 리노공업과 ISC의 밸류에이션 리레이팅 사례를 보면, 공통적으로 비메모리향 매출 성장이 핵심 동력으로 작용했다. 리노공업은 2020년 모바일 AP 고도화 및 5G 상용화를 계기로 비메모리 매출이 급증하며 PER이 15~20배에서 30배 수준으로 확대됐다. 실제로 2021년 리노공업의 매출액과 영업이익은 각 2,802억 원(+39.2% YoY), 1,171억 원(+50.4% YoY)으로 증가했으며, 비메모리 매출 비중은 97%에 달했다. ISC 또한 2023년 NVIDIA AI GPU향 소켓 공급이 가시화되면서 PER이 최대 36배까지 상승했다. 두 기업 모두 고단가 비메모리 제품의 매출 비중 확대가 리레이팅을 이끌었다.

리노공업 12M Fwd P/E 및 당기순이익 추이



자료: FnGuide Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

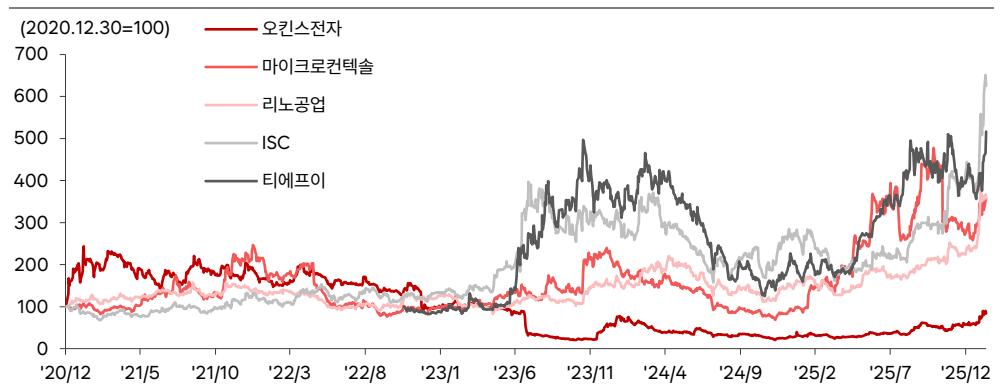
ISC 12M Fwd P/E 및 당기순이익 추이



자료: FnGuide Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

실제로 국내 반도체 후공정 테스트 부품 기업들의 최근 5개년 주가를 살펴보면, 2H23이후 ISC, 티에프이의 경우 러버 소켓 기술 기반의 고마진 비메모리 반도체형 매출 비중 확대로 주가가 크게 상승했다. 티에프이는 상장 당시 2025년 비메모리 매출 비중 50% 달성을 목표로 제시했는데, 3Q25 누적 기준 비메모리 매출 비중이 66.6%를 달성해 최근에도 차별화된 주가 흐름을 보여주고 있다. 반도체 후공정 테스트 부품 기업들의 주가는 2H25이후 데이터센터형 LPDDR 채용 및 AI형 메모리 소켓 테스트 시장 기대감에 따라 2025년 연초 대비 주가상승률 평균은 119.8%를 기록했다(2024년 국내 후공정 테스트 부품 기업 YTD -37.0%).

국내 반도체 후공정 테스트 부품 기업 주가 추이



자료: FnGuide Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

AI 수요의 패러다임 전환: 비메모리에서 Advanced 메모리로

당사 리서치센터는 최근 AI 산업의 초점 변화에 주목한다. 연산 능력(GPU) 중심에서 대용량 데이터 처리를 위한 메모리 성능으로 관심이 이동하면서, HBM을 중심으로 한 Advanced 메모리가 AI 성장의 수혜가 가능하다. 테스트 소켓 기업들이 비메모리형 매출액의 폭발적인 실적 성장 기대감으로 리레이팅을 받았던 것처럼, 국내 메모리 테스트 기업의 AI 인프라 수요 증가에 따른 실적 개선과 주가 상승을 기대한다.

동사의 현주가는 2026F PER 19.2x이며, Peer 업체의 2026F 평균 PER는 39.5x 수준이다. Peer 업체로는 국내의 반도체 테스트 소켓 업체들을 선정했다. 리노공업(42.9배)과 ISC(45.7배)는 비메모리 AI GPU형 소켓 시장에서의 독보적 위치와 기술력을 바탕으로 프리미엄 밸류에이션을 부여받고 있다. 특히 WinWay Technology는 중국 시장에서의 강

력한 입지와 성장 기대감으로 2025F PER 65.4배의 가장 높은 밸류에이션을 형성하고 있다. 동사와 유사한 밸류에이션 수준을 보이는 기업은 티에스이(17.8배)와 마이크로컨텍솔(10.6배)이다. 오킨스전자의 피어 대비 상대적 주가 부진은 1) 오버행 디스카운트와 2) 비메모리향 내러티브 차이에 기인한 것으로 판단된다. 먼저 수급 측면에서, 동사는 2023년 180억 원 규모(총주식수 대비 16.18%)의 CB를 발행했으며, 2025년 9월 전환기간 도래 이후 F(재무적투자자)의 차익 실현 물량이 출회되면서 주가에 부담으로 작용한 것으로 보인다. 실제로 2025년 4월 이후 주가는 상승 흐름을 보였으나, 전환 가능 물량에 대한 경계감이 확대되었다. 한편, 국내 주요 경쟁사인 마이크로컨텍솔은 AI 가속기용 소켓 샘플 공급 등 비메모리 밸류체인 확장 스토리가 부각되며, 상대적으로 선명한 투자 내러티브가 있었던 것으로 판단된다.

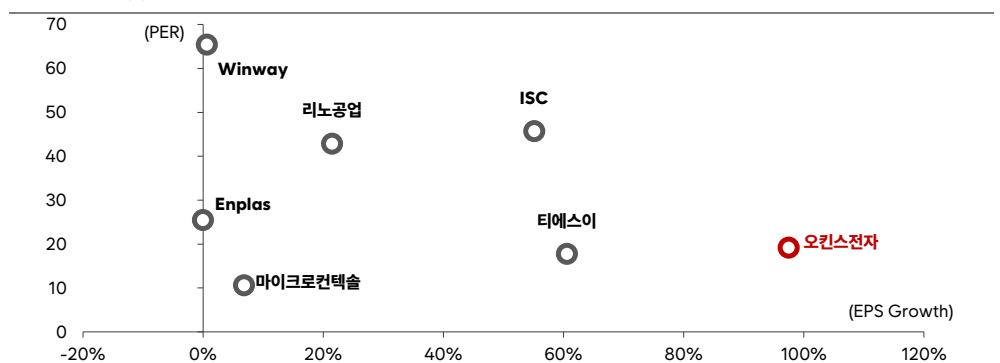
오킨스전자는 기존 번인 소켓에서 AI향 메모리 테스트 소켓, 포고핀, 고부가 마그네틱 콜렛까지 테스트 밸류체인 전반으로 매출 기반을 확장하고 있다. 2025년 큰 폭의 실적 개선을 통해 고정비 레버리지 효과가 가시화되기 시작했으며, CLT 전환에 따른 메모리 소켓 및 포고핀 매출 증가로 2026년 이후에도 이익 성장세가 이어질 것으로 전망된다. HBM4 및 LPDDR 수요 확대에 따른 EPS 성장률이 가시화되고, 추가적으로 AI 메모리향 다이 캐리어 소켓 매출이 추가될 경우 중장기적으로 Peer 평균 수준에 근접한 밸류에이션 확대가 가능할 것으로 기대한다.

동종 업종 밸류에이션

지수 및 기업명	종가 (원)	시가총액 (십억원)	매출액(십억원)			PER(배)			PBR(배)		
			2024	2025F	2026F	2024	2025F	2026F	2024	2025F	2026F
코스피	5,522	4,427,124	3,752,926	3,043,048	3,437,053	-	19.0	9.8	-	1.8	1.6
코스닥	1,126	617,365	334,105	101,539	118,537	-	51.9	29.4	-	3.8	3.3
오킨스전자	14,910	307	67	94	141	n/a	26.1	19.2	2.9	4.1	5.9
마이크로컨텍솔	20,200	168	70	97	104	4.0	11.4	10.6	0.7	2.1	1.8
리노공업	98,100	7,476	278	364	429	25.78	52.1	42.9	4.7	10.4	8.8
ISC	175,600	3,722	174	216	292	28.0	68.7	45.7	2.8	6.7	5.9
티에스이	86,100	952	348	413	479	10.7	27.7	17.8	1.3	2.6	2.3
WinWayTechnology	5,005	8,368	246	360	534	34.1	109.1	65.4	7.4	30.0	25.4
Enplas	13,740	1,269	348	396	421	9.8	28.9	25.5	0.7	2.1	1.9
동종업종 평균						21.7	57.3	39.5	2.9	9.0	7.7

주: 2026년 2월 12일 종가 기준. 동종그룹 25F, 26F는 시장 컨센서스 사용, 자료: FnGuide QuantWise, Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

EPS Growth 및 PER



주: 2026년 기준, 자료: FnGuide QuantWise, 한국IR협회의 기업리서치센터

리스크 요인
1 메모리 업황과의 실적 연동성
테스트 부품의 사업 구조상
전방 메모리 반도체 업황과 연동

동사는 반도체 테스트용 소모성 부품을 주력으로 영위하고 있어, 사업 구조적 측면에서 전방 산업인 메모리 반도체 업황과 높은 상관관계를 가질 수밖에 없다. 역사적으로 메모리 반도체 산업은 수요와 공급의 불균형에 따른 가격 변동성이 크고, 호황과 불황을 1~3년 주기로 반복해왔다. 현재는 생성형 AI 수요 확대에 따른 HBM 및 고사양 메모리 중심의 업황 호조가 지속되고 있으나, 메모리 산업의 변화를 계속해서 살펴봐야 한다. 향후 AI 투자 모멘텀의 둔화, 공급 과잉에 따른 가격 하락, 또는 거시경제 불확실성 확대 등으로 인해 메모리 업황이 하락 반전될 경우, 동사의 실적 역시 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 유의할 필요가 있다.

다만, 동사는 이러한 업황 연동 리스크를 완화하기 위한 사업 다각화를 적극 추진하고 있다. 기존 주력이었던 후공정 패키지 테스트 소켓에서 나아가, 전공정 웨이퍼 테스트에 사용되는 프로브 카드형 포고핀 매출이 확대되고 있으며, 반도체 테스트 서비스 사업 역시 매출 기여도가 높아지고 있다. 이는 동사의 사업 포트폴리오가 반도체 전공정부터 후공정까지 테스트 밸류체인 전반으로 확장되고 있음을 의미해 긍정적이라 판단된다.

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
매출액	642	569	667	944	1,405
증가율(%)	8.2	-11.4	17.3	41.5	48.9
매출원가	513	460	529	687	1,010
매출원가율(%)	79.9	80.8	79.3	72.8	71.9
매출총이익	129	108	138	257	395
매출이익률(%)	20.1	19.1	20.6	27.2	28.1
판매관리비	103	111	119	136	188
판매비율(%)	16.0	19.5	17.8	14.4	13.4
EBITDA	105	84	118	244	292
EBITDA 이익률(%)	16.3	14.8	17.7	25.8	20.8
증가율(%)	10.8	-19.5	40.0	106.8	19.7
영업이익	26	-3	19	121	207
영업이익률(%)	4.1	-0.5	2.9	12.8	14.7
증가율(%)	1.1	적전	흑전	533.2	71.6
영업외손익	-14	6	-63	-36	-29
금융수익	8	43	17	25	28
금융비용	28	37	79	71	62
기타영업외손익	6	-0	-1	10	5
총속/관계기업관련손익	-0	-0	0	0	0
세전계속사업이익	11	3	-44	85	178
증가율(%)	-32.3	-69.8	적전	흑전	110.1
법인세비용	-19	-7	10	4	18
계속사업이익	30	10	-54	80	160
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	30	10	-54	80	160
당기순이익률(%)	4.7	1.8	-8.1	8.5	11.4
증가율(%)	78.4	-66.7	적전	흑전	99.0
자배주주지분 순이익	29	10	-54	80	160

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
영업활동으로인한현금흐름	76	72	106	117	128
당기순이익	30	10	-54	80	160
유형자산 상각비	71	78	90	111	76
무형자산 상각비	7	9	9	12	9
외환손익	4	1	0	0	0
운전자본의감소(증가)	-29	-8	-16	-83	-112
기타	-7	-18	77	-3	-5
투자활동으로인한현금흐름	-136	-124	-150	-129	-120
투자자산의 감소(증가)	-4	-10	-11	-10	-15
유형자산의 감소	0	0	2	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-120	-99	-141	-100	-100
기타	-12	-15	0	-19	-5
재무활동으로인한현금흐름	14	54	-11	3	-48
차입금의 증가(감소)	63	9	11	1	1
사채의증가(감소)	0	74	-15	-163	114
자본의 증가	0	0	0	166	-163
배당금	0	0	0	0	0
기타	-49	-29	-7	-1	0
기타현금흐름	-3	0	0	100	100
현금의증가(감소)	-49	2	-56	91	61
기초현금	166	116	118	63	154
기말현금	116	118	63	154	215

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
유동자산	339	412	339	520	750
현금성자산	116	118	63	154	215
단기투자자산	15	75	31	36	44
매출채권	91	114	127	170	253
재고자산	100	98	107	145	215
기타유동자산	16	6	11	16	23
비유동자산	487	503	533	438	368
유형자산	350	364	416	305	229
무형자산	33	31	24	30	21
투자자산	79	83	72	83	98
기타비유동자산	25	25	21	20	20
자산총계	826	915	871	957	1,119
유동부채	376	295	465	307	448
단기차입금	166	185	196	196	196
매입채무	16	19	26	32	47
기타유동부채	194	91	243	79	205
비유동부채	120	261	130	129	152
사채	0	145	0	0	0
장기차입금	91	76	77	77	77
기타비유동부채	29	40	53	52	75
부채총계	496	555	595	436	600
자배주주지분	327	357	273	519	516
자본금	88	88	88	103	103
자본잉여금	214	237	234	385	222
자본조정 등	-47	-42	-38	-38	-38
기타포괄이익누계액	-3	-8	-34	-34	-34
이익잉여금	74	81	23	103	263
자본총계	330	359	276	522	519

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025F	2026F
P/E(배)	114.0	155.4	N/A	26.1	19.2
P/B(배)	9.9	4.5	2.9	4.1	5.9
P/S(배)	5.1	2.8	1.2	2.2	2.2
EV/EBITDA(배)	33.6	21.9	9.8	9.0	11.1
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPS(원)	161	58	-306	394	778
BPS(원)	1,849	2,018	1,545	2,543	2,509
SPS(원)	3,630	3,216	3,772	4,622	6,828
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	8.4	3.0	-17.2	20.3	30.9
ROA	3.8	1.2	-6.1	8.8	15.4
ROIC	11.6	-0.5	5.0	19.2	30.5
안정성(%)					
유동비율	90.2	139.8	72.8	169.5	167.5
부채비율	150.4	154.6	215.7	83.5	115.6
순차입금비율	78.4	70.9	135.6	22.2	31.3
이자보상배율	1.2	-0.1	0.6	4.2	7.7
활동성(%)					
총자산회전율	0.8	0.7	0.7	1.0	1.4
매출채권회전율	7.2	5.6	5.5	6.4	6.6
재고자산회전율	7.0	5.7	6.5	7.5	7.8

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
오킨스전자	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2026.02.19	오킨스전자-반도체 테스트 시장의 올라운더
2023.04.11	오킨스전자-아이템 다각화

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/irsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '소중한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '가치한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.